

# TUTORIAL PARA PROJETO DE CÉLULA UTILIZANDO FERRAMENTAS CADENCE

Fernando Gehm Moraes  
24 / setembro / 2023

## DOWNLOAD DOS ARQUIVOS E ÁRVORE DE DIRETÓRIOS

Logar-se na máquina *kriti* com o usuário fornecido pelo professor:

```
ssh -X <usuario>@kriti.inf.pucrs.br
```

**De casa:** fazer xpra na kriti (ou paxos)

Fazer o download do lab4 e executar os seguintes comandos:

```
wget https://fgmoraes.github.io/microel/lab4/lab4.tar
tar -xvf lab4.tar
cd lab4
```

O conteúdo do diretório layout é dado abaixo (comando *tree -a*):

lab4	
-- .cdsinit	→ <i>arquivo do design kit</i>
-- .cshrc_cmos065	→ <i>arquivo do design kit</i>
-- .ucdprod	→ <i>arquivo do design kit</i>
-- cds.lib	→ <b>indica as bibliotecas de trabalho</b>
-- characterization	
-- liberate.tcl	→ <b>script para caracterizar eletricamente a célula projetada</b>
-- gera_abstract.txt	→ <b>script para gerar o modelo físico da célula projetada</b>
-- sim	
-- anel.sp	→ <i>spice para simular um anel de inversores</i>
-- inv.sp	→ <i>spice para um inversor</i>
-- st65.scs	→ <i>arquivos da tecnologia com modelos elétricos dos transistores</i>
`-- synthesis	
-- cmd_genus	→ <b>script para síntese lógica</b>
-- cmd_innovus	→ <b>script para síntese física</b>
-- load.tcl	→ <b>parâmetros para o script da síntese lógica</b>
-- src	
-- anel.vhd	→ <i>VHDL que instancia a célula projetada</i>

## Conteúdo do relatório a ser entregue

1. **Esquemático (10%)** - *print screen* da tela e *print screen* do console com mensagem se houve ou não erro no esquemático.
2. **Layout do inversor (30%)** [print screen da tela]
3. **Relatório do DRC (5%)** [tela que indica se houve ou não erros]
4. **Relatório do LVS (5%)** [tela que indica se houve ou não erros]
5. **Extração elétrica (5%)**. Apresentar os arquivos:
  - inv.pex.spi
  - inv.pex.spi.inv.pxi
  - inv.src.net
6. **Simulação elétrica (10%)**. Curvas da simulação e o atraso. O atraso é dado copiando-se os dados do arquivo *inv.measure*. Simulação do anel do inversor para com **21 inversores**. Curvas com a simulação e a indicação da frequência de operação (obtido do arquivo *anel.measure*)
7. **Layout da view abstract (5%)**. Print screen da tela da view abstract e o arquivo texto LEF.
8. **Geração do arquivo de caracterização elétrica (5%)** – adicionar a homepage gerada pela ferramenta (*datasheet/index.html*) no relatório
9. **Síntese lógica (10%)** – apresentar o esquemático gerado pela ferramenta de síntese. **Modificar** o anel para 13 inversores (12 inversores mais uma NAND). No tutorial temos 11 inversores (10 inversores mais uma NAND).
10. **Síntese física (15%)** – apresentar o layout para 13 inversores, e o relatório de DRC.

## CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE

Executar os seguintes comandos para abrir o ambiente de projeto de células da CADENCE, **no diretório lab4**:

```
source /soft64/source_gaph; module load ic/5.1.41
```

```
csh
```

```
source .cshrc_cmos065
```

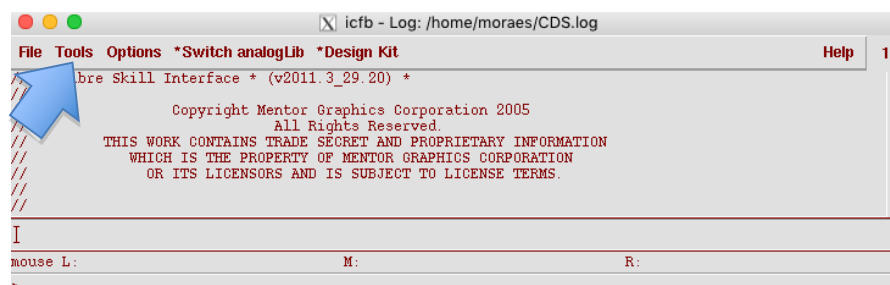
```
setenv CDS_AUTO_64BIT
```

```
icfb &
```

→ opcional: para evitar incompatibilidade com 32 bits

→ se não abrir o icfb: **icfb -nosplash &** (só se houver erro ao invocar o icfb)

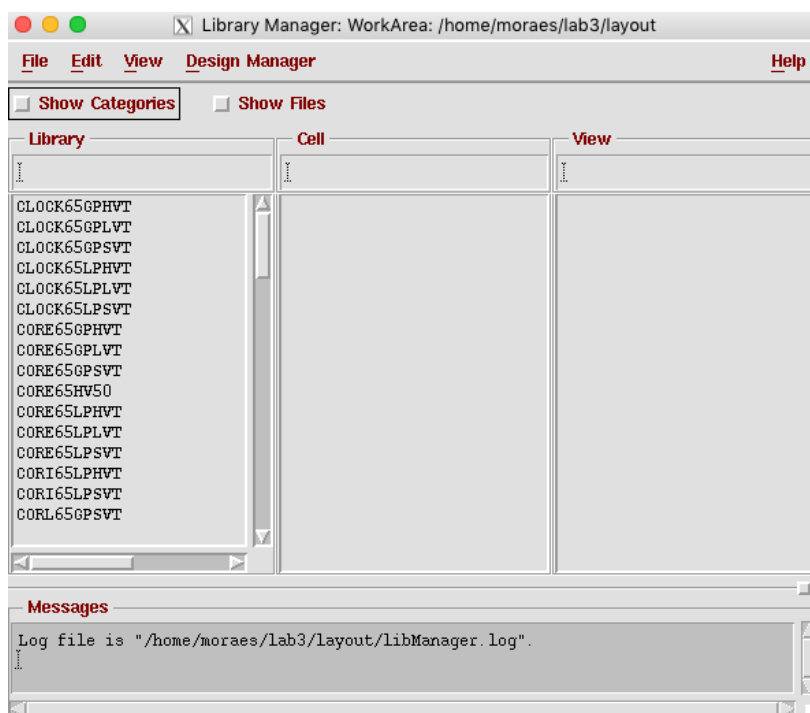
Abrirá a seguinte janela (demora um pouco para carregar todas as bibliotecas):



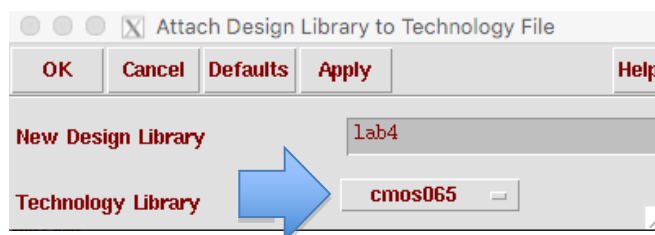
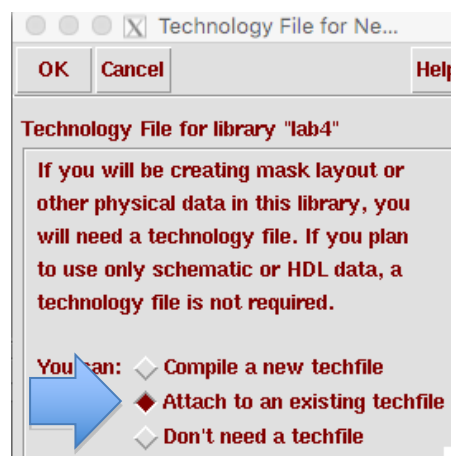
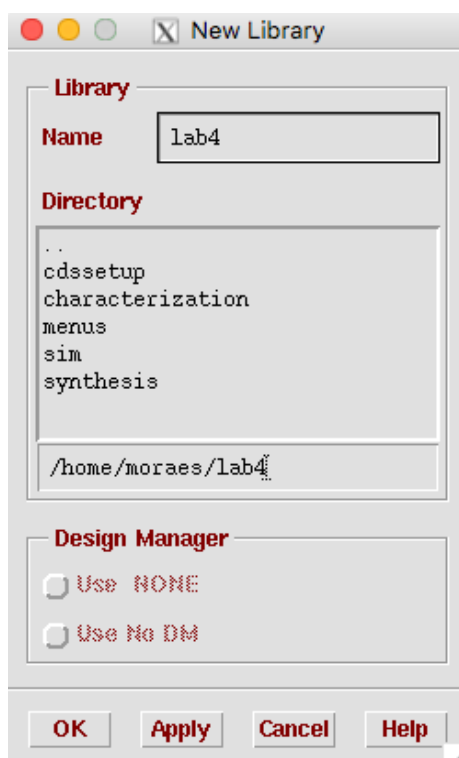
## 1 - CRIANDO O ESQUEMÁTICO

Utilizar a ferramenta *icfb* para os seguintes passos:

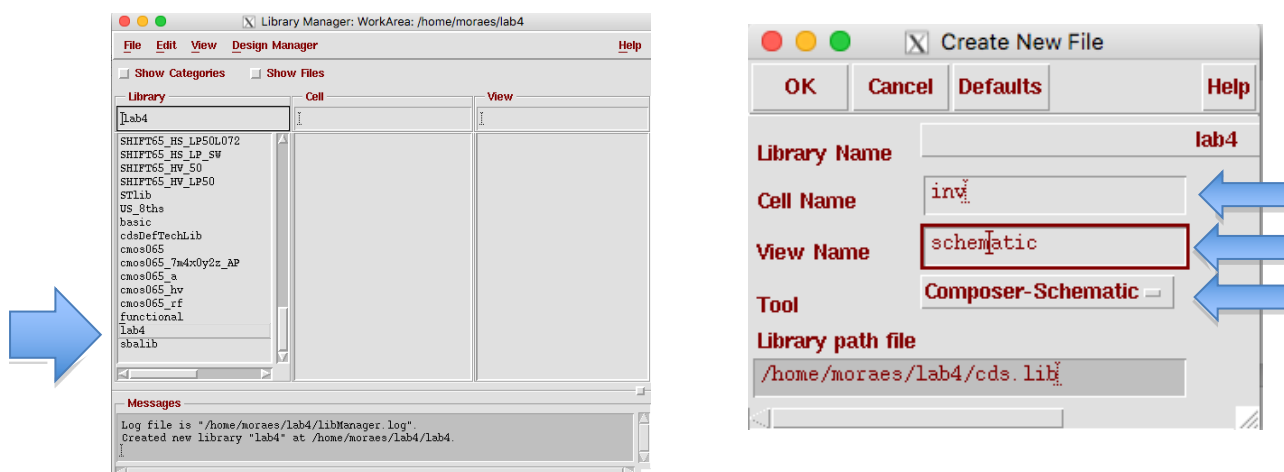
- a) Primeiro abrir o Library Manager: **Tools→Library Manager...**



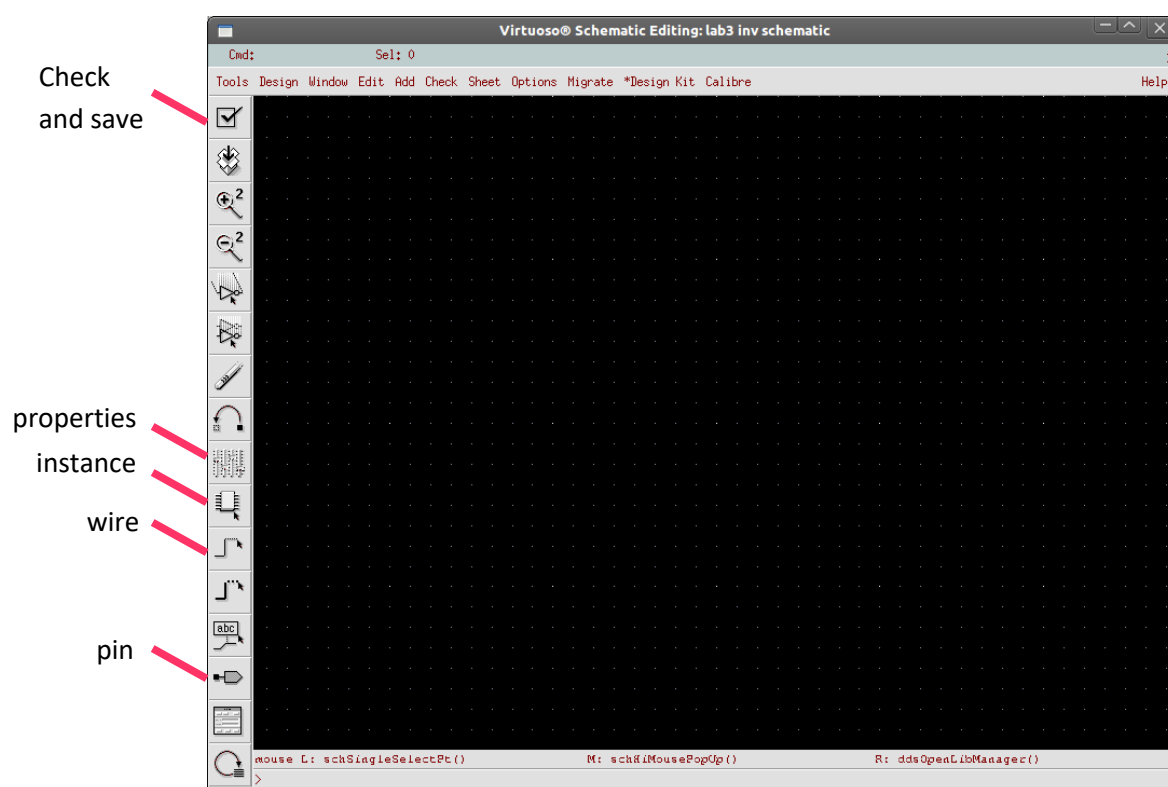
- b) Criar a biblioteca onde os *layouts* serão gravados: **File→New Library**. Ao clicarmos em OK abre a janela da biblioteca de referência. Marcar a opção “*Attach to an existing techfile*” para que a biblioteca faça uso dos modelos disponíveis no design kit. Clicar em ok. Selecionar a tecnologia “**cmos065**”.



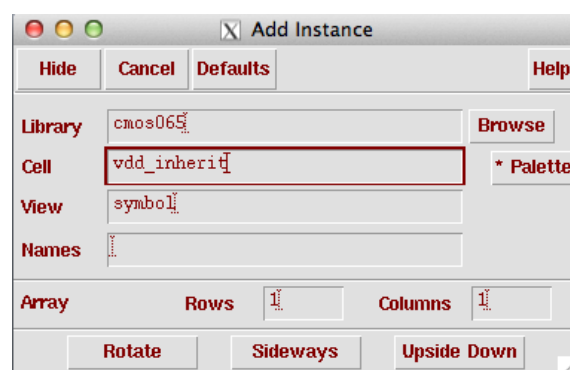
- c) Agora, criar o esquemático do inversor: No Library Manager, **selecionar** a biblioteca criada e clicar em **File → New → Cell View...** Digitar o nome da célula que será projetada, selecionar a ferramenta “Composer-Schematic”, dar um nome a visão (“schematic”) e clicar em ok.



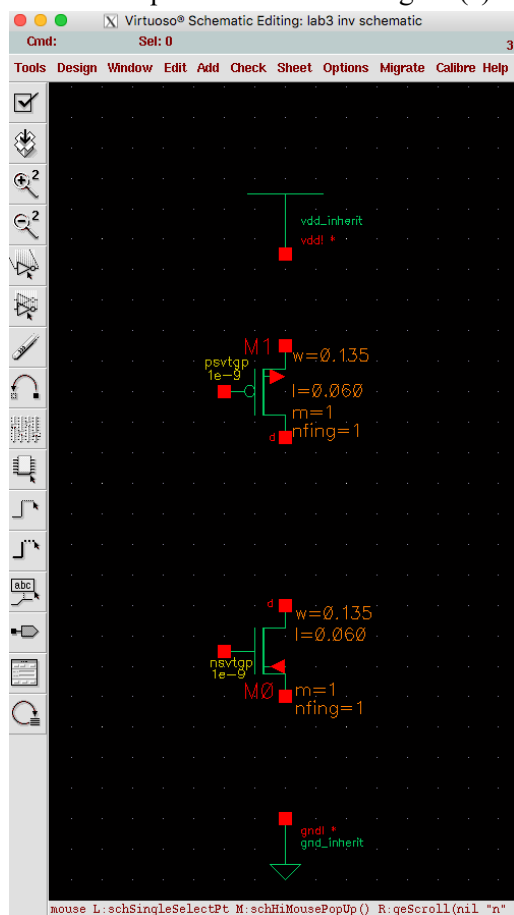
O resultado é a interface gráfica da ferramenta de edição de esquemáticos.



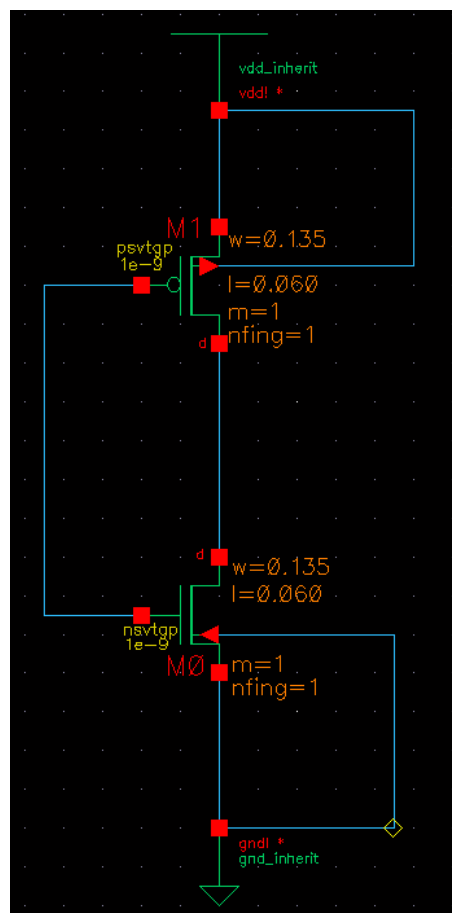
- d) Instanciar a fonte de alimentação da célula e massa: clicar em *instance* (ou apertar a tecla “i”), clicar em browse, escolher a biblioteca **cmos065**, escolher a célula “**vdd\_inherit**”, view “**symbol**” e instanciá-la no esquemático, clicando em qualquer lugar da janela do *schematic editor* (para sair teclar ESC). Repetir o processo escolhendo a célula “**gnd\_inherit**”. **DICA: PODE-SE ESCREVER O NOME DA CÉLULA NO CAMPO “cell” do Library Browser**.



- e) Agora deve-se instanciar dois transistores, um PMOS e um NMOS, para gerar o esquemático que implementa a lógica do inversor. Para tanto deve-se: clicar em *instance*, clicar em *browse*, selecionar a biblioteca cmos065 e instanciar o símbolo da célula “**nsvtgp**”. Repetir o processo, instanciando a célula “**psvtgp**”. Notar que as dimensões dos transistores são definidas para mínimas por default ( $L=0.060\ \mu\text{m}$  e  $W=0.135\ \mu\text{m}$ ). O resultado deve se um esquemático similar à figura (a) abaixo.

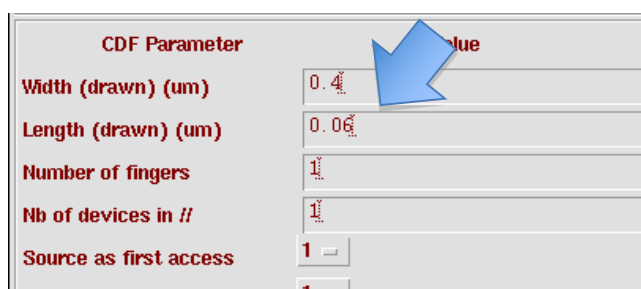


(a) Esquemático com as instâncias

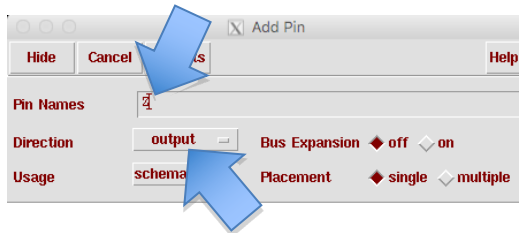
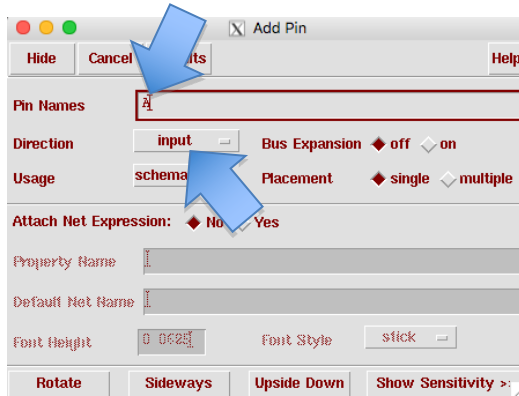


(b) Esquemático com adição dos fios conectando as instâncias

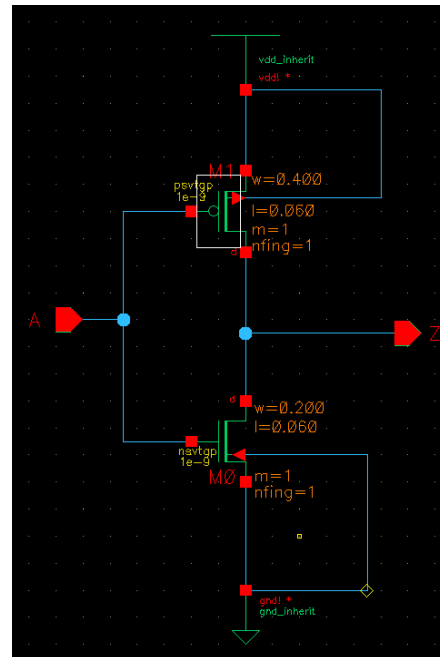
- f) O próximo passo é clicar em *wire* (ou apertar a tecla “w”) e conectar os dispositivos a fim de implementar a lógica do inversor. Deve-se obter um esquemático equivalente ao que está representado na figura (b) acima. **Notar que o bulk do PMOS deve ser conectado a vdd! e o do NMOS a gnd!**
- g) Dimensionar os transistores para os seguintes tamanhos: **transistor N para  $0.2\ \mu\text{m}$  e o transistor P para  $0.4\ \mu\text{m}$** . Dessa forma obteremos uma célula com tempos de propagação balanceados. Para redimensionar os transistores: selecionar o dispositivo, clicando no mesmo, *nsvtgp* ou *psvtgp*, clicar em *property* (ou apertar a tecla “q”), procurar o parâmetro “Width” e modificá-lo para 0.2 ou 0.4, respectivamente. Clicar em ok.



- h) Agora criar os pinos de entrada e saída. Para tanto, clicar em *pin* (ou apertar a tecla “p”). Criar um pino de entrada, definindo a direção (*Direction*) para “input” e nomeando-o. Para o pino aparecer clicar na janela do esquemático. Executar o mesmo procedimento para criar um pino de saída, porém dessa vez a direção deve ser definida para “output”. **USAR os nomes A e Z.** Depois conectar os pinos à entrada e saída do inversor.



(a) Inserção dos pinos



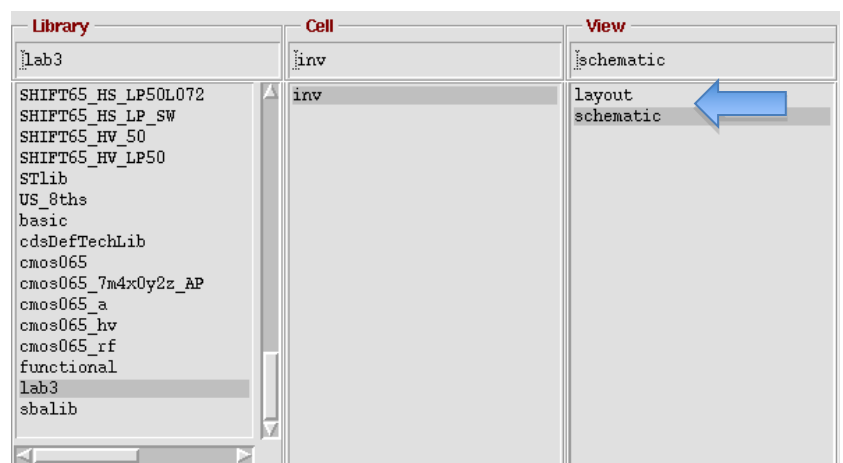
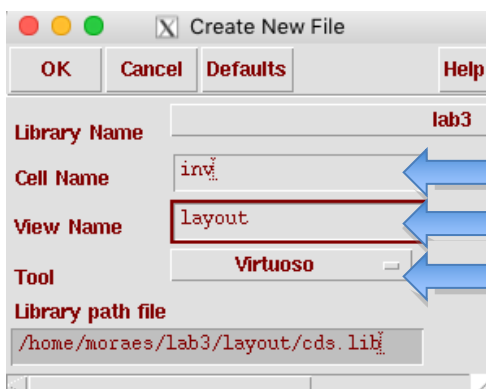
(b) Esquemático completo

- i) Clicar em **Check and Save**. Se nenhuma mensagem de alerta/erro for gerada (na janela *icfb* – a menor), a célula está estruturalmente correta.



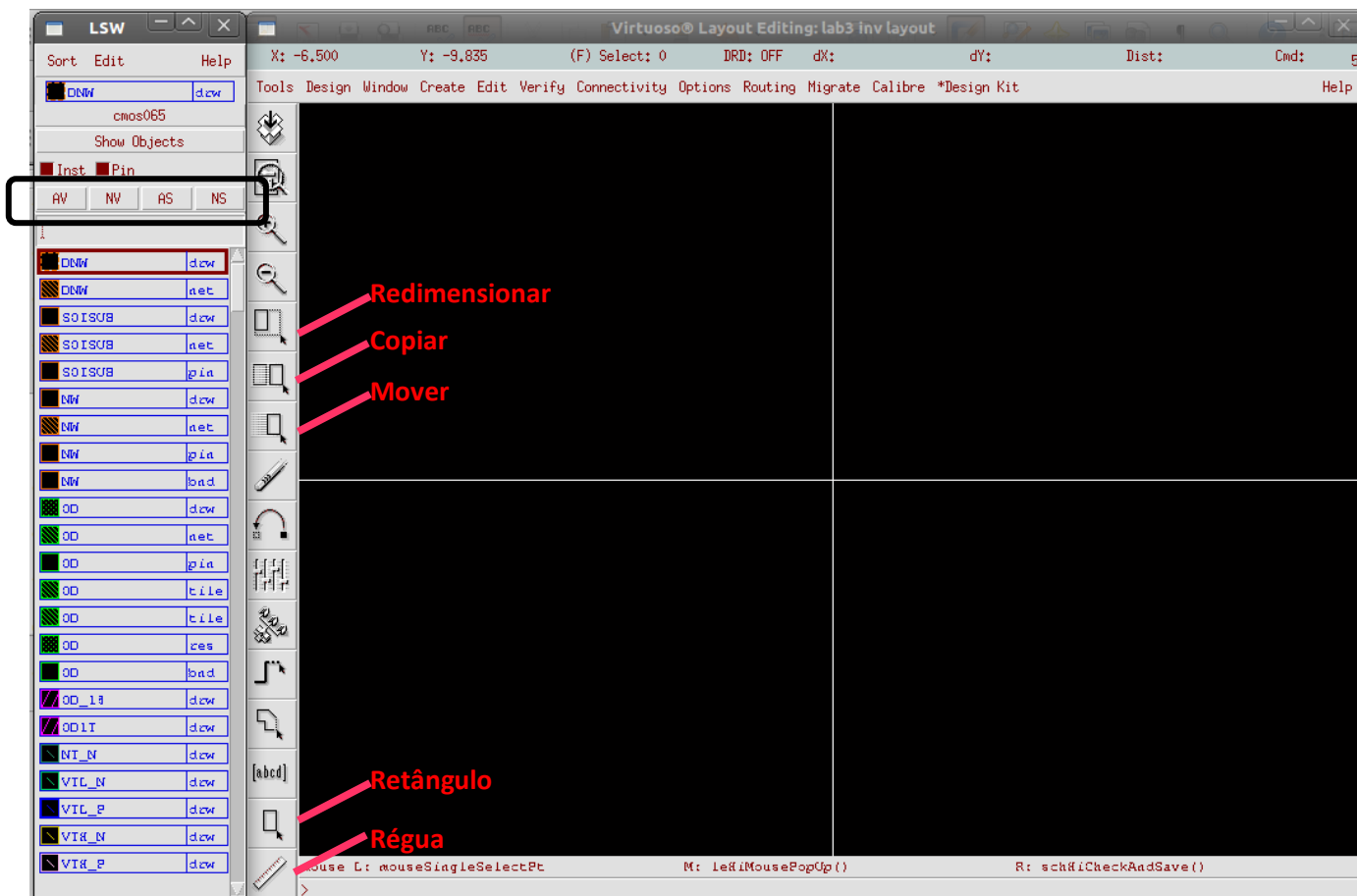
## 2 - DESENHANDO O LAYOUT

Agora criar a “visão” (view) layout: no Library Manager clicar em **FILE** → **New** → **Cell view**. Selecionar a biblioteca previamente criada (no caso *lab4*), digitar o nome da célula que iremos desenhar, a **visão layout** e selecionar a ferramenta **Virtuoso**.



Notar que a célula *inv* agora tem duas “views”: *layout* e *schematic*.

O resultado é a interface gráfica da ferramenta, com a **lista de camadas à esquerda** (janela LSW).



- ☐ **NOTAR NA JANELA (PALETTE) DA ESQUERDA:**
  - ☐ **AV** - todos os níveis visíveis
  - ☐ **NV** – nenhum nível visível – pode-se **desabilitar** tudo e só habilitar para edição um nível desejado – **MUITO ÚTIL PARA VISUALIZAR UM SÓ NÍVEL (exemplo metal 1)**
  - ☐ **AS** - todos os níveis selecionáveis
  - ☐ **NS** – nenhum nível selecionável – pode-se desabilitar tudo e só habilitar para seleção um nível desejado – **MUITO ÚTIL PARA SELEÇÃO DE UM DADO NÍVEL (exemplo: só metal 1)**
- ☐ **DICAS DA INTERFACE GRÁFICA:**
  - ☐ A régua pode ser invocada pelo atalho “k” do teclado e todas réguas são apagadas ao utilizar-se o atalho “shift+k”.
  - ☐ O local onde o layout está armazenado é definido de forma absoluta no arquivo **cds.lib**. Por exemplo, no meu caso: “**DEFINE lab4 /home/moraes/lab4/layout/lab4**”. Se o layout for copiado para outra máquina este arquivo deve ser editado manualmente.
  - ☐ Observar no topo da janela as coordenadas e as dimensões do retângulo que se está desenhando.
  - ☐ A interface gráfica trabalha com um conceito de “**empilhamento**” de comandos. Cuidar o canto inferior esquerdo, o qual indica o comando ativo – no caso o desenho de um retângulo. Pode-se por exemplo estar-se inserindo um retângulo e fazer-se zoom (F ou Z).
  - ☐ Os comandos de mover, zoom, apagar, salvar, esticar, undo, etc. concentram-se nos botões da esquerda da interface gráfica.
  - ☐ Para desfazer a última alteração no layout, pode-se usar o atalho “U” do teclado. Para refazê-la, o atalho “shift+U”.
  - ☐ Para visualizar todo o layout deve-se usar o atalho “F” do teclado.
  - ☐ A ferramenta de zoom pode ser usada fazendo-se um retângulo na área a ser visualizada com o botão direito do mouse.

- As regras de projeto serão dadas ao longo deste texto. Caso seja necessário, consultar o professor para regras mais detalhadas.

- Principais camadas utilizadas:

Nível	Nome	Observação
NW	Poço N	
OD	Área Ativa (DIFUSÃO)	
NP	Região N+	Local para os transistores N
PP	Região P+	Local para os transistores P
PO	Polisilício	
CO	Contato	
M1	Metal 1	
VIA1	Via	Conecta metal 1 ao metal 2
M2	Metal 2	
prBoundary DCO	Margens	Delimitam as margens da célula

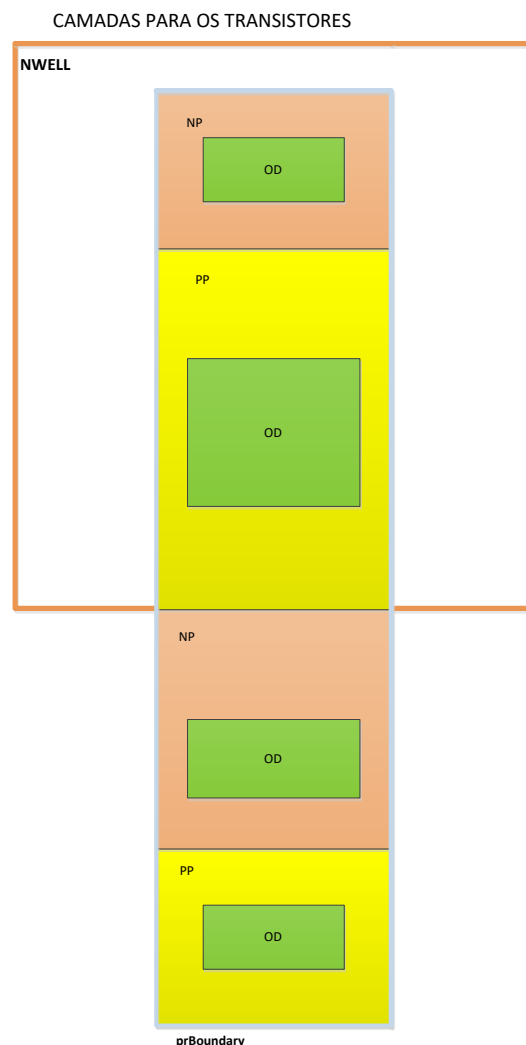
Exemplo de regras de projeto:

Nível	Largura Mínima	Espaçamento Mínimo	Overlap para CTM/V1M
PO (poli)	0,06 $\mu$ m	0,12 $\mu$ m	0,03 $\mu$ m
M1 (metal 1)	0,09 $\mu$ m	0,09 $\mu$ m	0,025 $\mu$ m

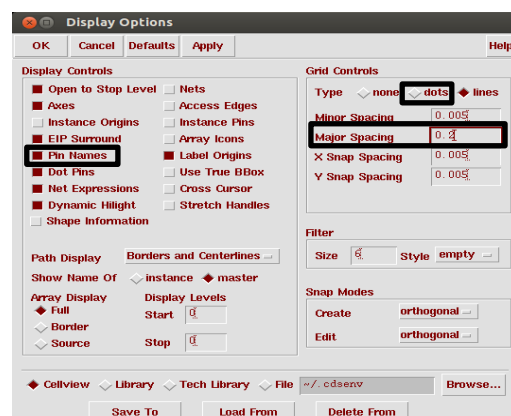
- Contatos (CO): 0,09  $\mu$ m x 0,09  $\mu$ m, com espaçamento entre contatos igual ou maior a 0,11  $\mu$ m
- Vias (VIA1): 0,1 x 0,1  $\mu$ m

O transistor N é formado por área ativa (OD), com N+ ao redor (NP).

O transistor P é formado por área ativa (OD), com P+ ao redor (PP), e poço N ao redor da área P+ (NWELL).



- Antes de iniciarmos o projeto físico do inversor, vamos explorar as opções de exibição. Para isto, ir no menu **“options → display”**.
- Selecionar a caixa **“pin names”**. Explorar as opções de display, que auxiliam o projeto físico da célula.
- Reparar os controles de grid de manufatura, *X Snap* e *Y Snap Spacing*. Esses valores devem sempre estar coerentes com especificações feitas pelo fornecedor da tecnologia utilizada. Nesse caso, ambos estão definidos para **0.005**. Isso significa que, para essa tecnologia, as dimensões de qualquer camada devem sempre ser múltiplas de **0.005  $\mu$ m**, tanto para o eixo X quanto para o eixo Y.



- Selecionar a opção **“dots”** e alterar o **major spacing** para **0.2**.

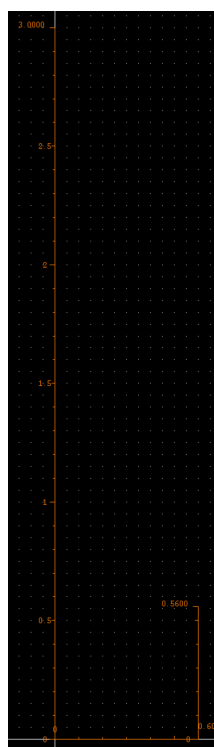
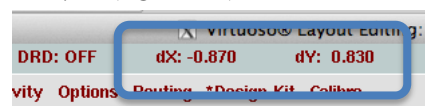
**Para criar um retângulo, deve-se primeiro selecionar a camada desejada na janela LSW.** O próximo passo é usar o botão “Retângulo” (atalho “R” no teclado), clicar em qualquer lugar do editor de layout, arrastar o mouse e clicar novamente, fazendo assim um retângulo da camada escolhida. Para acertar as dimensões, usar a ferramenta “Régua” (tecla “K” do teclado) para medir o tamanho desejado, e a ferramenta “Redimensionar”



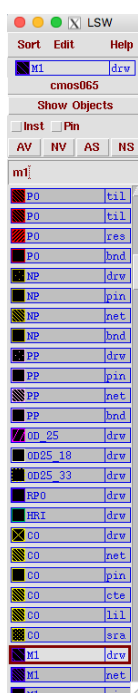
(atalho “S”) para definir o novo tamanho. Para redimensionar, clicar na borda do retângulo e arrastar o mouse até obter-se o tamanho desejado, então clicar novamente. Cuidar para que as bordas dos retângulos respeitem o *grid*.

- L1. Começar fazendo uma régua de  $0,6 \mu\text{m}$  (horizontal) por  $3 \mu\text{m}$  (vertical) (figura L1). Nota uma terceira régua de  $0,56 \mu\text{m}$ .
- L2. Selecionar a camada **M1 (drawing)** na janela LSW (figura L2).
- L3. Desenhar dois retângulos de M1 (metal 1)  $0,6 \mu\text{m} \times 0,56 \mu\text{m}$  - serão os fios de alimentação (figura L3). **Respeitar a altura de  $3 \mu\text{m}$** . (o segundo retângulo pode ser desenhado copiando-se o primeiro).
- L4. Selecionar a camada **OD (drawing)** na janela LSW – difusão para implementar os transistores. Desenhar um retângulo de difusão com dimensão  $0,48 \mu\text{m} \times 0,2 \mu\text{m}$  – centrado no metal1 ( $0,06+0,48+0,06=0,6$ ) com distância entre o M1 e OD igual a  $0,255 \mu\text{m}$  (figura L4).
- L5. Desenhar outro retângulo de difusão com dimensão  $0,48 \mu\text{m} \times 0,4 \mu\text{m}$  (figura L5)
- L6. Selecionar a camada **M1 (drawing)** na janela LSW (figura L2). **Desenhar 4 retângulos** de M1 sobre os drenos/sources – nos transistores P os retângulos são de  $0,15 \mu\text{m} \times 0,4 \mu\text{m}$ , e nos transistores N os retângulos são de  $0,15 \mu\text{m} \times 0,2 \mu\text{m}$ . **Desenhar dois retângulos** de M1 conectando os *sources* à alimentação. Largura do M1:  $0,09 \mu\text{m}$  (figura L6).
- L7. Desenhar um retângulo de M1 conectando os *drenos*. Largura do M1:  $0,09 \mu\text{m}$  (figura L7).

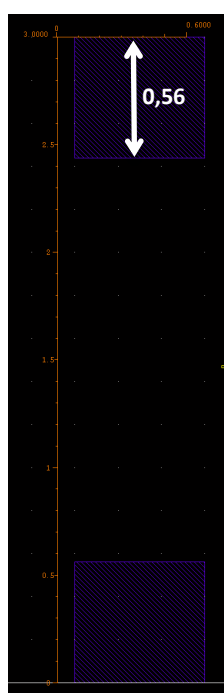
**DICA: acompanhar o tamanho do retângulo no topo da janela: dX e dY.**



**L1**



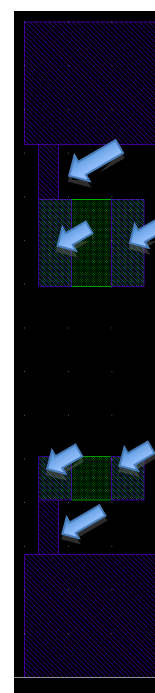
**L2**



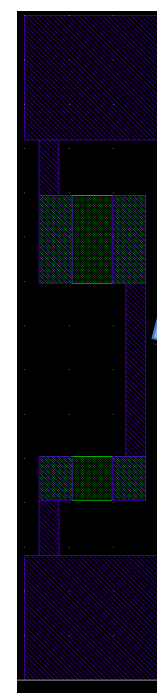
**L3**



**L4 / L5**



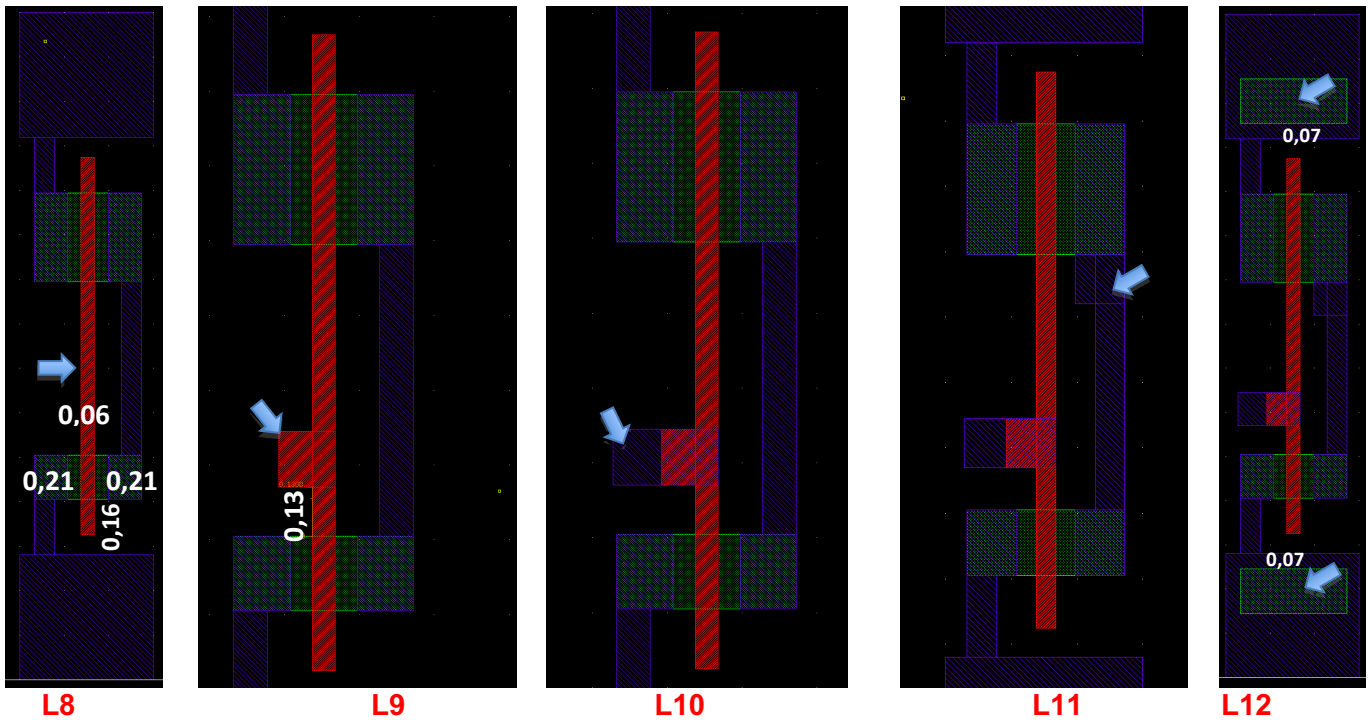
**L6**



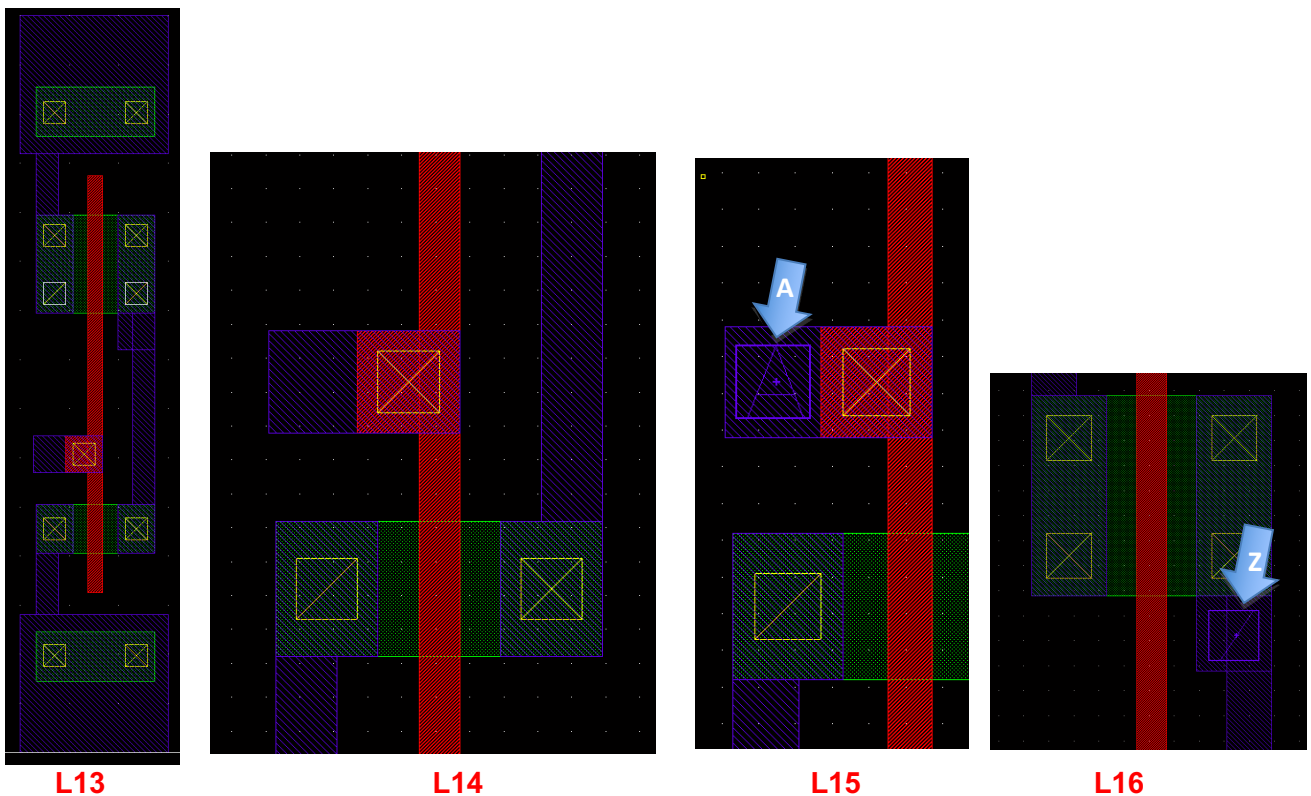
**L7**

- L8. Inserir um retângulo de polisilício, responsável pela definição das regiões de *gate*. Desenhar um retângulo de poli, camada **PO (drawing)**. Esse retângulo deve ter **largura de  $0,06 \mu\text{m}$**  e se sobrepor à difusão, representando assim o *gate* do transistor ( $0,21+0,06+0,21=0,48$ ). Importante: deve haver uma “sobra” mínima de  $0,16 \mu\text{m}$  após as difusões (figura L8).
- L9. Inserir um retângulo polisilício, responsável pela conexão do *gate* ao mundo externo – quadrado de  $0,15 \mu\text{m} \times 0,15 \mu\text{m}$ , com distância de  $0,13 \mu\text{m}$  em relação à difusão (figura L9).
- L10. Inserir um retângulo metal, responsável por “subir” à conexão do *gate* para metal1 – quadrado de  $0,28 \mu\text{m} \times 0,15 \mu\text{m}$  (figura L10). Este retângulo deve superpor-se ao retângulo de poli do item anterior.

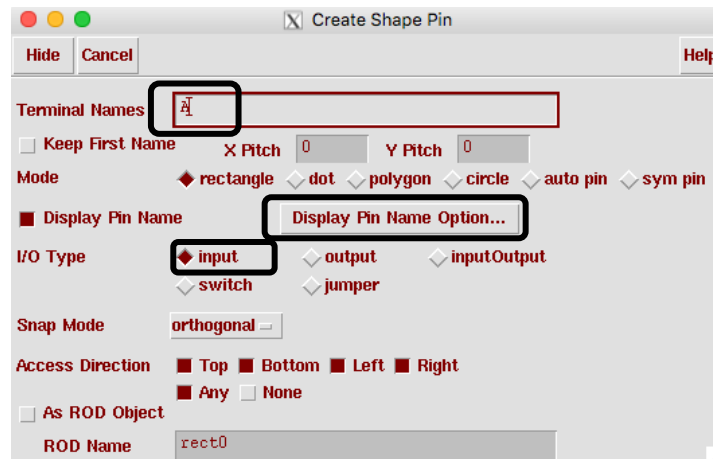
- L11. Inserir um quadrado de  $0,15 \mu\text{m} \times 0,15 \mu\text{m}$  em metal1, junto aos drenos, para inserção do pino de saída (figura L11).
- L12. **Copiar** o retângulo de difusão da parte N para as regiões de alimentação. Estes retângulos de difusão serão responsáveis pela polarização de substrato. Colar este retângulo com uma margem de  $0,07 \mu\text{m}$  em relação ao metal 1 (figura L12).



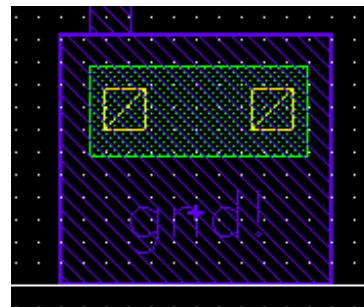
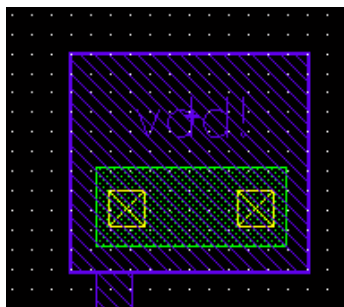
- L13. Inserir os contatos – camada **CO drw**. Os contatos são quadrados de  $0,09 \mu\text{m} \times 0,09 \mu\text{m}$ , com espaçamento entre contatos maior ou igual a  $0,11 \mu\text{m}$ , e devem ter uma margem **mínima** de  $0,03 \mu\text{m}$  em relação a qualquer borda. Teremos nos transistores N 1 contato por dreno/source, nos transistores P 2 contatos por dreno/source, nas difusões de polarização 2 contatos, e um contato entre o poli e o metal 1 do *gate* (figura L13).



- L14. **Inserção dos pinos.** Até o momento trabalhamos apenas com camadas de desenho (drw). Para os pinos iremos utilizar as camadas PIN. **Selecionar a camada M1 (pin) na janela LSW.** Faça um zoom na região do contato de gate (figura L14).
- L15. Clicar em *Create* → *Pin* (atalho “ctrl p”), **selecionar o modo shape pin**, definir o pino como **input** e dar um nome ao pino (**A**). **Esse nome deve ser o mesmo dado ao esquemático.** Clicar em “*Display Pin Name Option*” e modificar o valor de **Height** para **0.1**. Clicar em **Ok**. **Clicar em hide**, clicar em qualquer lugar do editor de layout. Desenhar um quadrado 0,1 x 0,1 μm (deixar o “+” do label dentro do quadrado), centralizado no metal ao lado do contato de *gate* (figura L15).



- L16. Repetir o processo de criação para o pino de saída (Z): Desta vez selecionar o I/O type “output” e posicioná-lo no centro do quadrado de metal (figura L16).
- L17. Criar dois novos pinos, para as linhas de alimentação. Primeiramente criar um pino com a camada M1 (pin), direção “input” e nome **vdd!** (com exclamação mesmo). Este pino deve ter o **mesmo tamanho da camada M1** desenhada para a linha de alimentação na porção superior do layout e deve ser posicionada de forma a se sobrepor essa camada. Este procedimento deve ser repetido, porém agora criando um pino cujo nome deve ser **gnd!** e posicionar sobre a camada de metal 1 da linha de alimentação na porção inferior do layout (figura L17).



L17

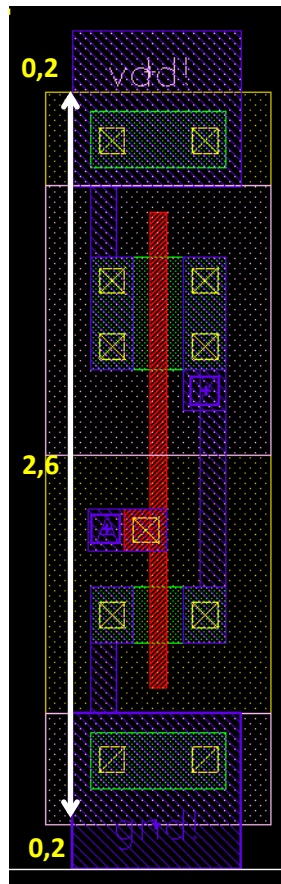
### Definição dos tipos de transistores

- L18. Inserção dos implantes. Os implantes definem o tipo da difusão: N ou P. Desenhar os quatro retângulos de implante N e P, na seguinte ordem:

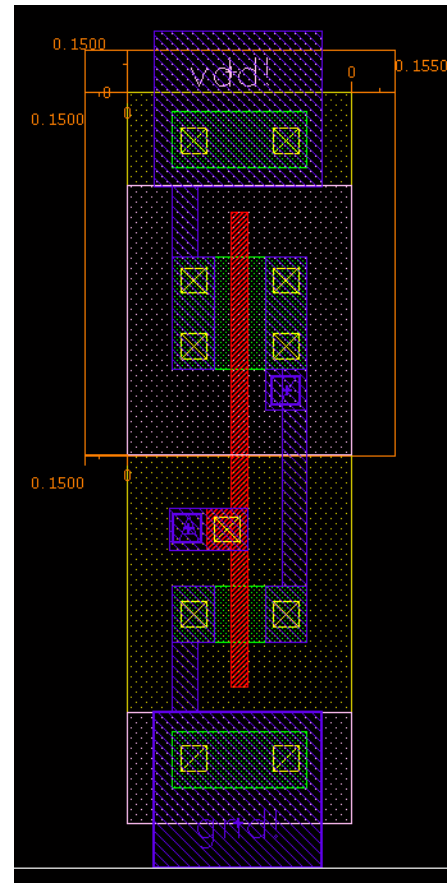
- (1) **PP drw**, sobre a linha de alimentação gnd!, retângulo de **0,78 (X) x 0,36 (Y)** (0,11 de cada lado);
- (2) **NP drw**, do primeiro retângulo até o centro da célula (**0,78 (X) x 0,94 (Y)**);
- (3) **PP drw**, do retângulo NP drw até o metal de vdd! (**0,78 (X) x 0,94 (Y)**);
- (4) **NP drw**, sobre a linha de alimentação vdd!, retângulo de **0,78 x 0,36**;

**Todos os 4 retângulos devem ter a mesma largura e devem ser justapostos** (figura L18)

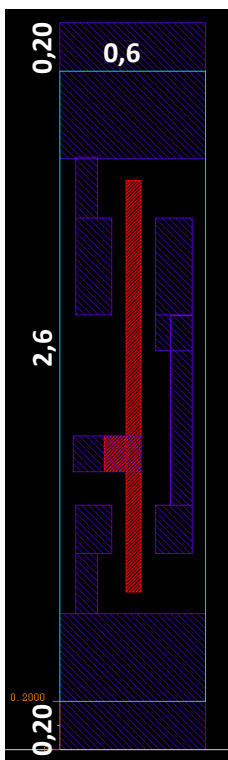
L19. Inserção do poço N. Selecionar a camada de poço N (**NW drw**), e fazer um retângulo com margem de 0,15 m ao redor dos dois retângulos de implante superiores (figura L19).



L18



L19



L20

## L20. Terminando a célula

A última etapa do layout é inserir as camadas de fronteira: *prBoundary* e *DCO*

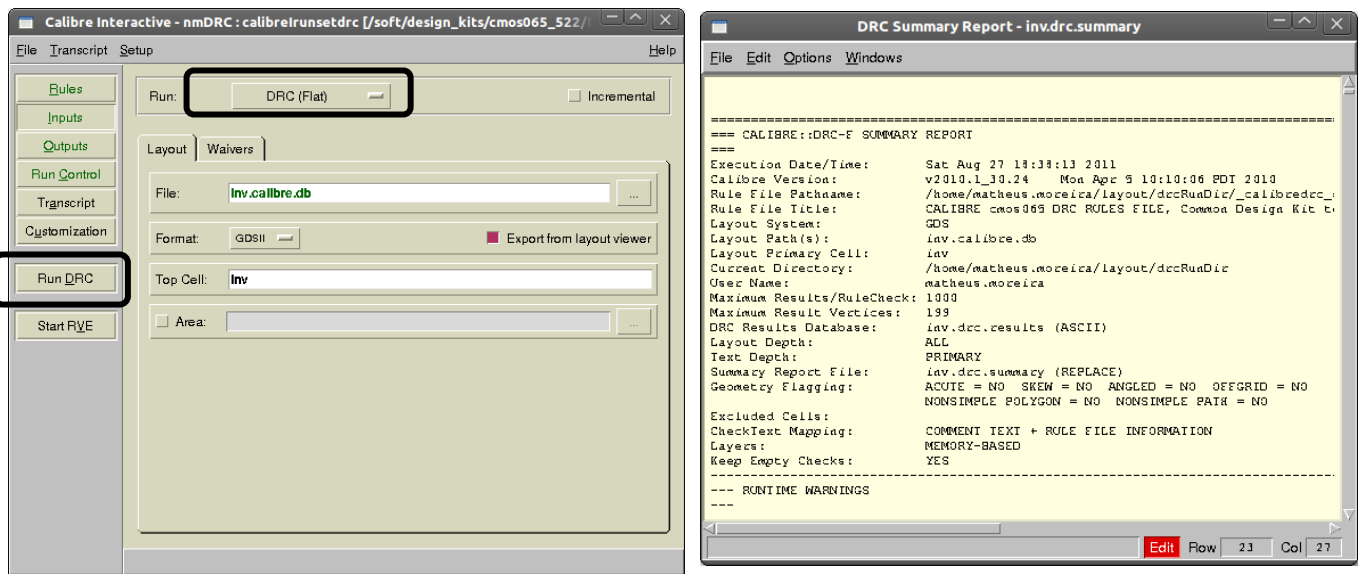
- ☐ Exibir apenas o metal 1 (na janela LSW clicar em NV e depois M1). Na figura L20 tem o poli e o metal1.
- ☐ Selecionar a camada **prBoundary drw**, e fazer um retângulo de **0,6 m x 2,6 m**, como indicado na figura L20.
- ☐ Selecionar a camada **DCO drw**, e fazer um retângulo de **0,6 m x 2,6 m**, exatamente sobre o retângulo prBoundary.

### 3 – DRC - VERIFICANDO SE O DESENHO ESTÁ CORRETO

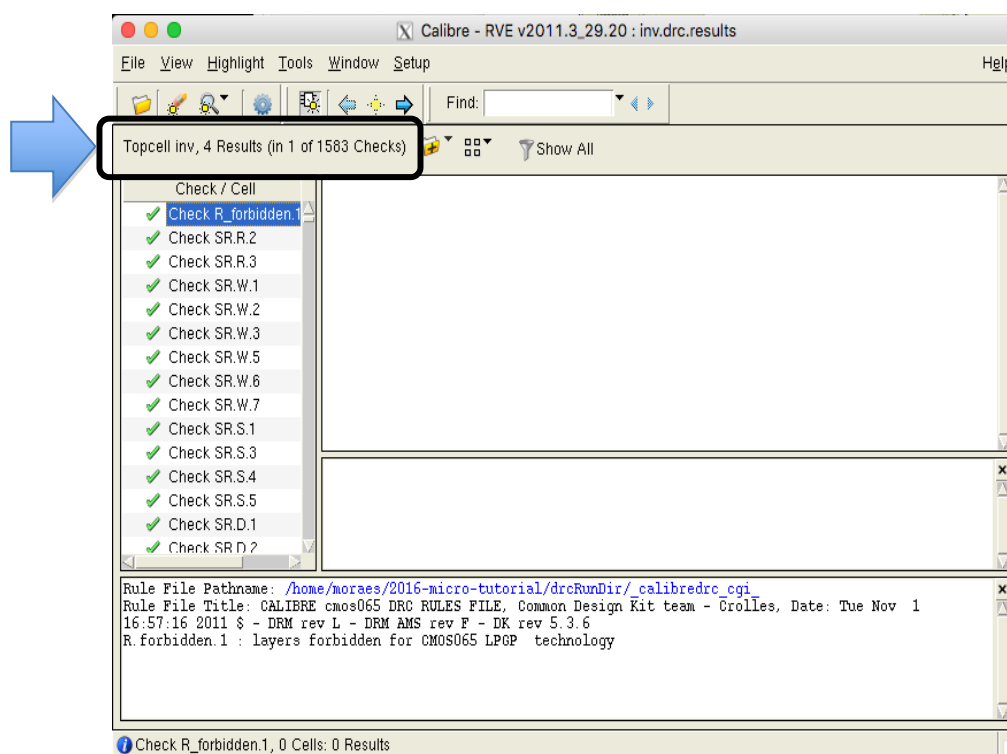
- ❑ **LEMBRAR DE SALVAR A CÉLULA!** Este passo é feito através da ferramenta Calibre DRC (*design rule checker*).
- ❑ Ir em “**Calibre → Run DRC**”, clicar em Run DK DRC e OK.



- ❑ Escolher o modo DRC (Flat), pois desenhamos o inversor sem instanciar nenhum bloco hierárquico. Clicar em Run DRC. Caso apareça a mensagem de sobrescrever o arquivo, clicar em ok. Será gerado um relatório geral da ferramenta, mostrando todos os passos executados na verificação do layout.

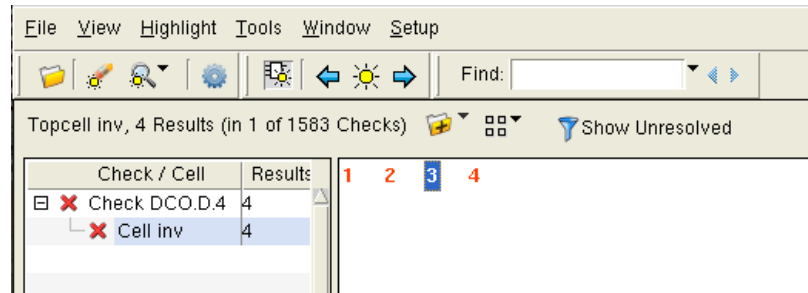


- ❑ A janela de resultados é apresentada abaixo. Notar que foram indicados 4 erros de DRC. Clicar no funil para filtrar apenas as regras que podem ter sido violadas, para assim corrigir o layout. Selecionar a opção “**Not Unresolved**” e clicar em *apply*.

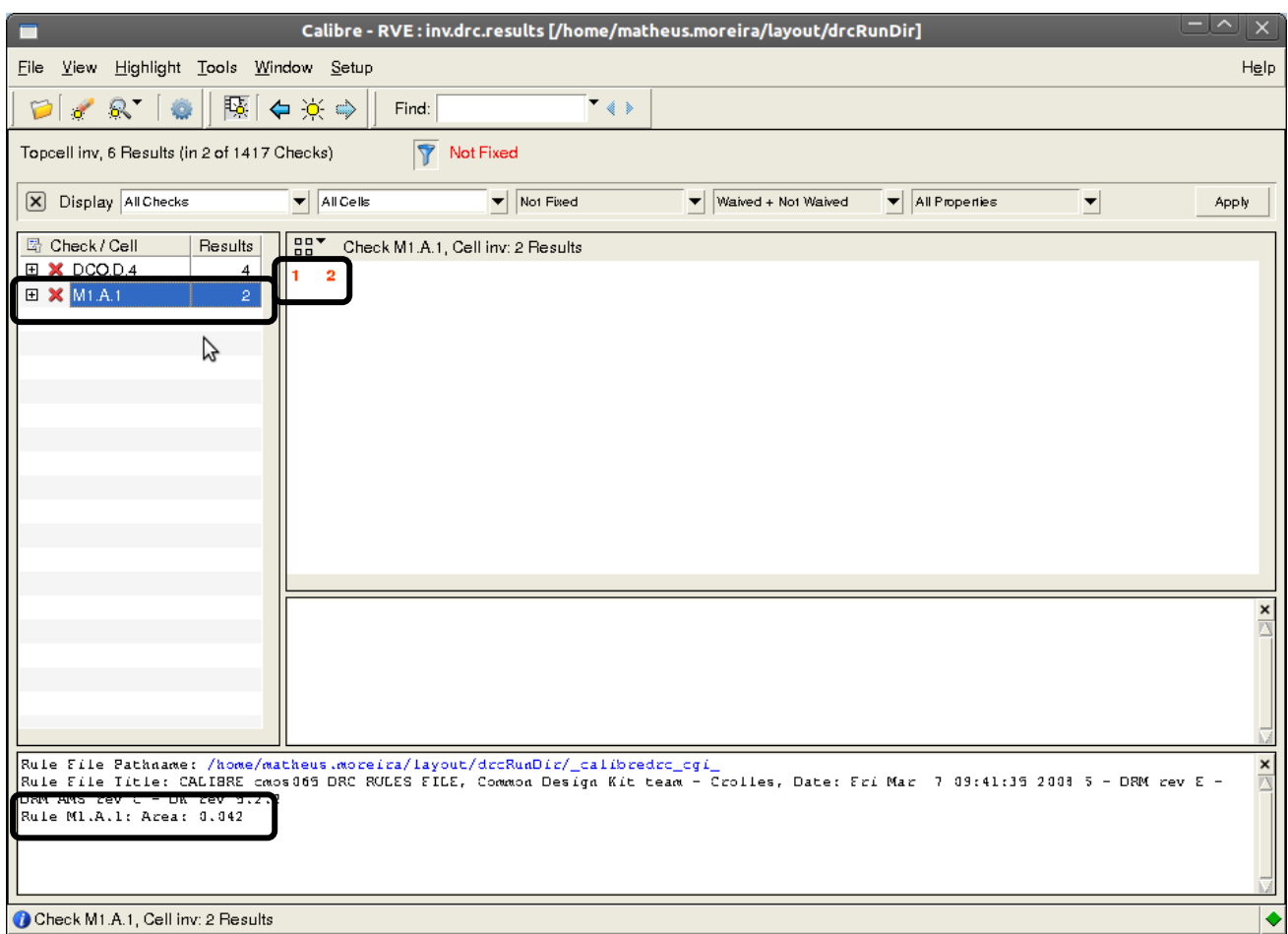




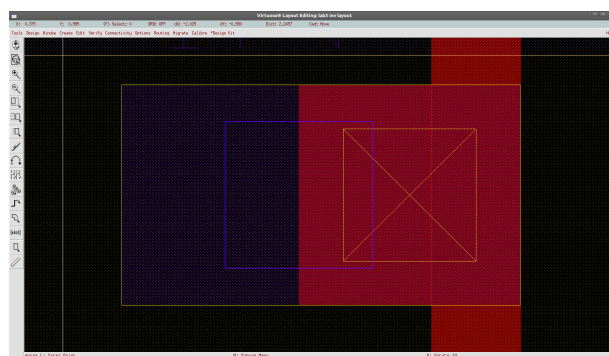
- Os 4 erros de DRC são referentes à camada DCO e podem ser ignorados.



- Havendo erros de DRC em camadas de desenho (*DRW*):
  - Serão sinalizados com o código da regra de projeto. Ao clicar na violação, será dada uma explicação do erro. Nesse caso, a regra de área mínima para metal 1 não foi respeitada em 2 ocasiões. Notar que o valor de área mínima é dado para que o layout seja corrigido.



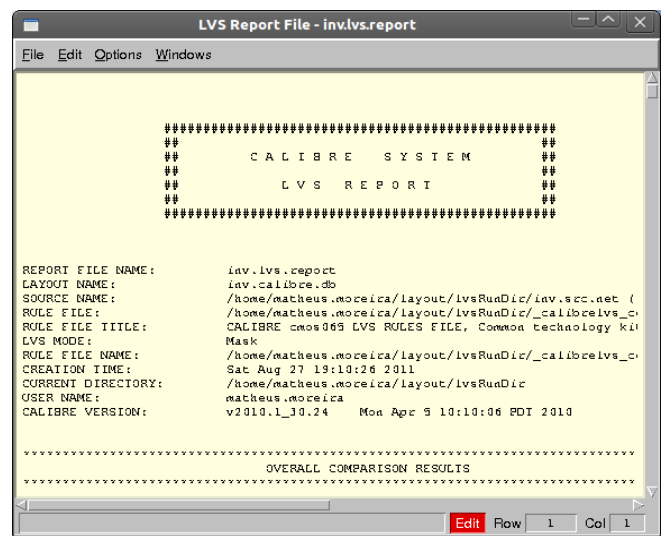
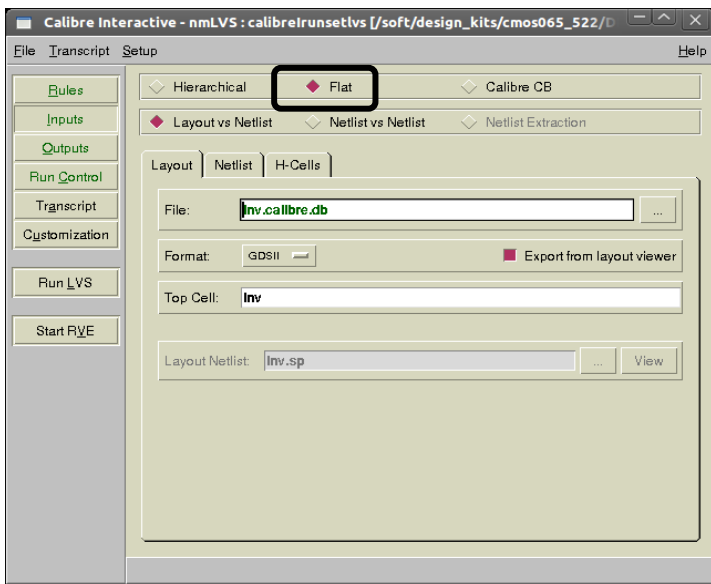
- Ao clicar duas vezes em uma das violações, a janela do virtuoso (com o layout) mostra exatamente onde essa violação acontece.



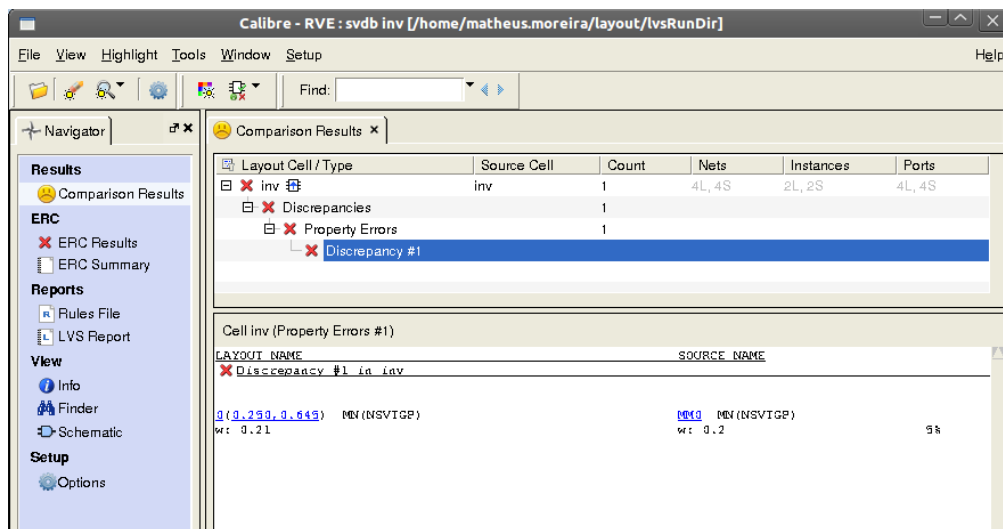
- Corrigir os possíveis erros de DRC e executar novamente a ferramenta de verificação. **Deixar o layout livre de violações nas camadas de desenho.** Essa verificação, garante que o layout projetado é “fabricável”. Quando uma fábrica recebe as máscaras de um layout, ela verifica se o layout respeita as regras de projeto físico. Se sim, o projeto será fabricado. Se não, ele retorna ao projetista.

#### 4 – LVS - VERIFICANDO SE O LAYOUT E O ESQUEMÁTICO SÃO EQUIVALENTES

- Essa verificação, LVS (*layout versus schematic*), garante que o layout projetado implementa a mesma lógica que o esquemático. Este passo é feito através da ferramenta Calibre LVS
- Ir em “**Calibre → Run LVS**”. Escolher o modo *Flat* novamente e clicar em Run LVS. Caso apareça uma mensagem de sobrescrever arquivo, clicar em OK.



- Na janela de resultados da verificação LVS exibe-se eventuais erros. Nesse exemplo, o layout não fecha com o esquemático. Ao expandir a discrepância, obtemos sua causa. Nesse caso, o transistor NMOS MN, desenhado no layout possui um W de 0.21  $\mu\text{m}$ , enquanto o transistor equivalente, do esquemático, possui um W de 0.20  $\mu\text{m}$ .

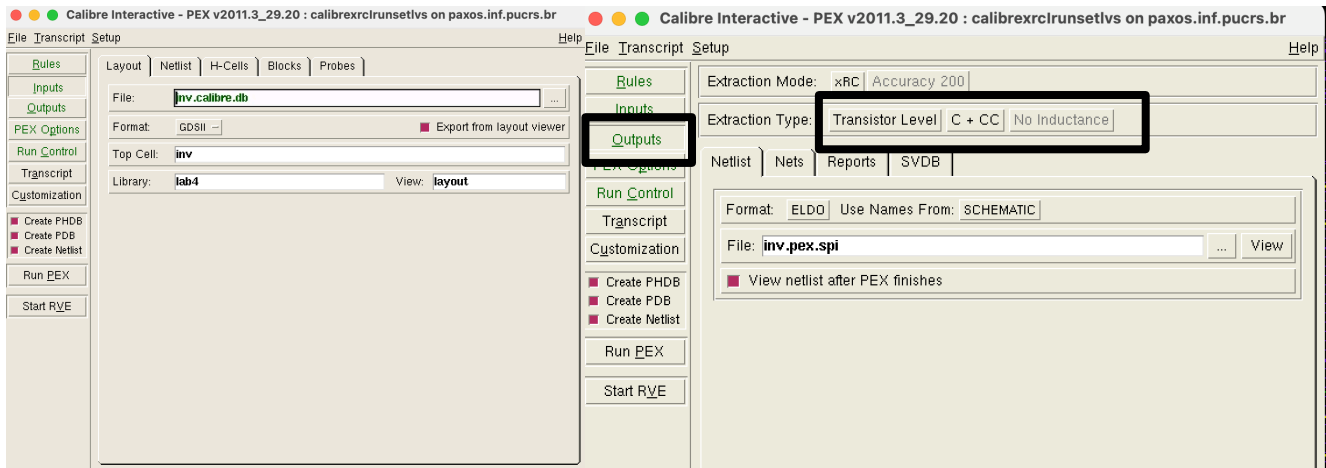






## 5 - EXTRAÇÃO ELÉTRICA

- Este passo é responsável pela realização da extração elétrica, ou seja, pela geração do netlist *spice*. Ir em “**Calibre → Run PEX**”. Usar as opções padrão e clicar em OK. Caso apareça alguma mensagem, solicitando para salvar o arquivo de configurações, clicar em não salvar. A ferramenta irá perguntar se deseja criar uma pasta para o ambiente PEX, clicar em criar. Clicar na opção “**Outputs**” da ferramenta, e escolher as opções de extração, **C+CC** e sem indutância. Clicar em Run PEX.



- Clicar em Run PEX. Serão geradas duas janelas, uma mostrando os parasitas extraídos e outra mostrando a descrição em *spice* do circuito obtido.

No.	Layout Net	Source Net	CC Total (F)	C+CC Total (F)
1	A	A	2.79315E-16	2.79315E-16
2	gnd!	gnd!	2.46155E-16	2.46155E-16
3	vdd!	vdd!	1.88254E-16	1.88254E-16
4	Z	Z	2.40562E-16	2.40562E-16

```

File Edit Options Windows

* File: inv.pex.spi
* Created: Thu Aug 11 15:10:44 2016
* Program "Calibre xRC"
* Version "v2011.3_29.20"
*
.subckt inv A Z
*
XM1 Z A vdd! vdd! psvtgp L=0.06 W=0.4 NFING=1 M=1 AS=0.0864 AD=0.0864 PS=0.832
+ PD=0.832 PO2ACT=0.21 NGCON=1 lpe=1
XM0 Z A gnd! gnd! nsvtgp L=0.06 W=0.2 NFING=1 M=1 AS=0.0434 AD=0.0434 PS=0.634
+ PD=0.634 PO2ACT=0.21 NGCON=1 lpe=1
X2_noxref gnd! vdd! dnwps AREA=1.60777 PJ=5.12
*
.include "inv.pex.spi.inv.pxi"
*
.ends
*

```

- Reparar que foram criados três arquivos que descrevem, em *spice*, o circuito extraído. No **terminal**, no diretório **pexRunDir**, encontram-se os arquivos com essas descrições. Nesse exemplo os arquivos são (eles deverão ser incluídos no relatório):
  - inv.pex.spi (**arquivo a ser utilizado para a simulação**)
  - inv.pex.spi.inv.pxi (capacitâncias parasitas)
  - inv.src.net (netlist)

## 6 - SIMULAÇÃO ELÉTRICA

**Fechar as ferramentas da Cadence, sair do csh, e configurar o simulador elétrico. Comandos:**

**exit**

**module purge**

**module load ic mmsim**

- Abrir o arquivo com a descrição spice do inversor (arquivo pexRunDir/inv.pex.spi) e modificar sua interface para que passe a possuir as entradas para as linhas de alimentação. Na linha que descreve o “.subckt (NOME\_DA\_CELULA)” é dada a pinagem do circuito. **Adicionar** ao final as duas entradas: vdd! e gnd!. No exemplo aqui descrito, o resultado é o seguinte:

```
* File: inv.pex.spi
* Created: Wed May 11 08:06:01 2022
* Program "Calibre xRC"
* Version "v2011.3_29.20"
*
.subckt inv  A Z vdd! gnd!
*
XM1 Z A vdd! vdd! psvtgp L=0.06 W=0.4 NFING=1 M=1 AS=0.0864 AD=0.0864 PS=0.832
+ PD=0.832 PO2ACT=0.21 NGCON=1 lpe=1
XM0 Z A gnd! gnd! nsvtgp L=0.06 W=0.2 NFING=1 M=1 AS=0.0434 AD=0.0434 PS=0.634
+ PD=0.634 PO2ACT=0.21 NGCON=1 lpe=1
X2_noxref gnd! vdd! dnwps AREA=1.566 PJ=5.06
*
.include "inv.pex.spi.inv.pxi"
*
.ends
*
```

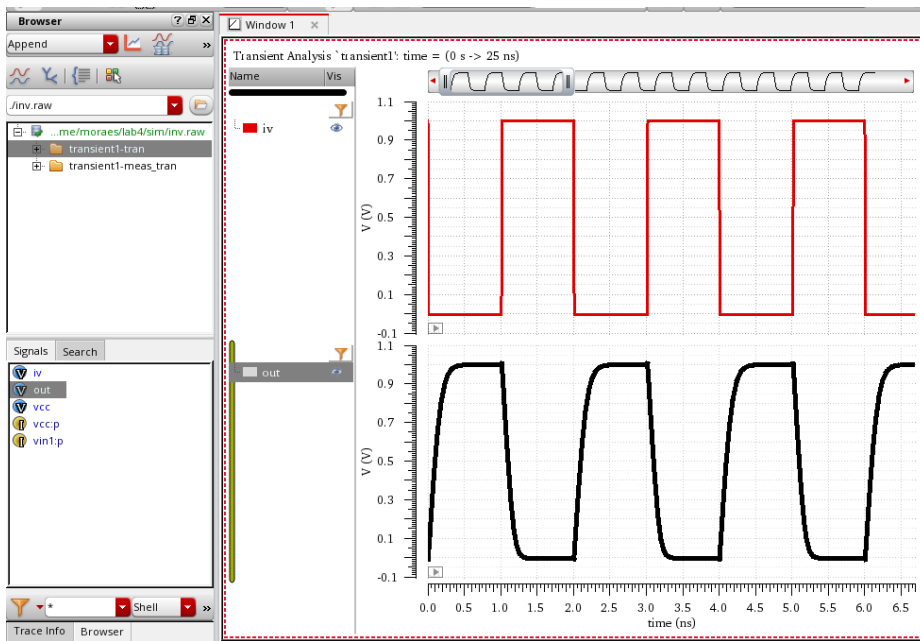
- Ir para o diretório de simulação: **cd sim**
- Abrir o arquivo **inv.sp**. Observar na linha 15 a inclusão do arquivo "../pexRunDir/inv.pex.spi" via comando include. Na linha 20 há a instanciação do subcircuito (X1 iv out vcc 0 inv ). **Este é o arquivo que gera os estímulos para o circuito que projetamos.**
- Executar a simulação elétrica: **spectre inv.sp**. Observar o arquivo **inv.measure**:

```
date           : 7:17:59 PM, Fri Apr 7, 2023
design          : * inversor - simulação do circuito extraído do layout projetado
simulator      : spectre
version        : 15.1.0.257
```

```
Measurement Name : transient1
Analysis Type    : tran
td               = 84.6095
tdescida         = 8.46095e-11
ts               = 91.964
tsubida          = 9.1964e-11
```

Ou seja, o tempo de subida é de 84.6 ps e o de descida 91.964 ps.

- Executar a ferramenta *viva*. Selecionar os probes no sinal de entrada e saída (iv e out) e enviá-los para o gráfico.



Nosso inversor funciona!

## Simulação elétrica de um anel de inversores

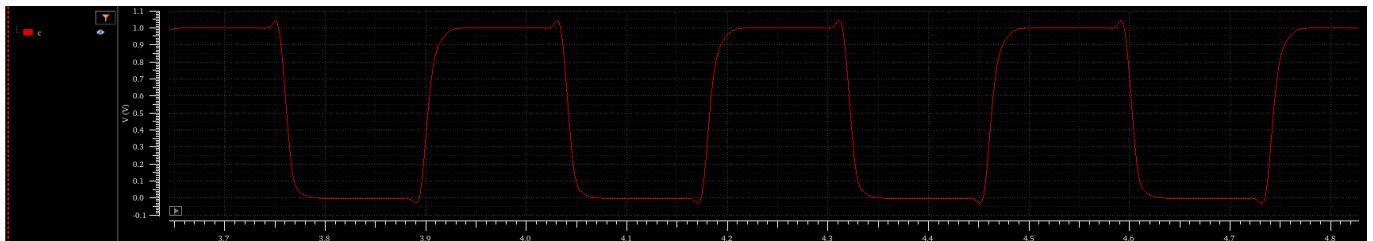
- Agora vamos simular um anel de inversores. Verifique se o arquivo **anel.sp** contém a referência correta ao arquivo extraído (`../pexRunDir/inv.pex.spi`) e as 15 instâncias fazem referência ao inversor. Executar o seguinte comando: **spectre anel.sp**

```
more anel_inv.measure
```

```
date           : 7:20:25 PM, Fri Apr 7, 2023
design          : * inversores em anel para cálculo de frequência com inversor
extraído       :
simulator      : spectre
version        : 15.1.0.257
```

```
Measurement Name : transient1
Analysis Type    : tran
freq_ghz         = 3.56905
periodo          = 0.280187
tf               = 6.27838e-12
tr               = 1.24008e-11
```

- Visualize a forma de onda do oscilador:



- **Alterar agora o anel para 21 inversores e fornecer no relatório a nova frequência. Lembrar de alterar o **measure** para considerar os 21 inversores:**

```
.measure tran periodo param = '(tf+tr) * 1e9 * 21'
.measure tran freq_ghz param = '1/periodo'
```

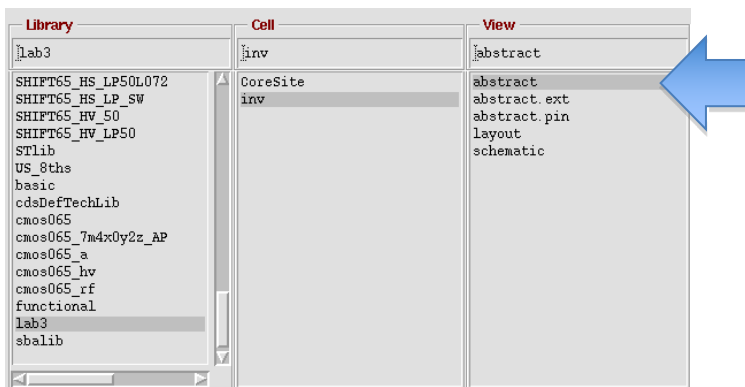
## 7 - MODELO ABSTRATO

- Agora, devemos criar o modelo abstrato para podermos usar a célula que projetamos em um circuito descrito em VHDL. Este modelo indica para a ferramenta a disposição dos metais de roteamento, que ela precisará utilizar na hora de colocar a células no circuito e interligá-las.
- **Este passo será por script.** Abra o *script* **gera\_abstract.txt** e verifique se os comandos a seguir conferem com a célula inversor:

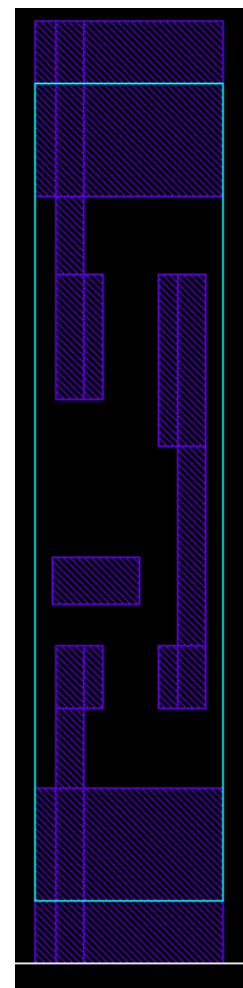
```
absSetLibrary("lab4")
absSetOption("ViewLayout" "layout")
absSetOption("ViewLogical" "schematic")
....
absSelectCell("inv")
```

- **Executar os passos abaixo** – o comando *abstract* pode demorar um pouco. Ele gera a *view* abstract e o arquivo *inv.lef*

- Executar: **module purge**
- carregar **"module load ic/5.1.41"** (não pode ser outra versão)
- ir para a pasta **".../<microX>/lab4"** e abrir o shell **"csh"**
- no csh executar **"source .cshrc\_cmos065"**
- Executar: **setenv CDS\_AUTO\_64BIT**  
(comando opcional, se houver erro na geração do LEF)
- após executar: **abstract -replay gera\_abstract.txt**
- abrir o icfb ( **icfb &** )



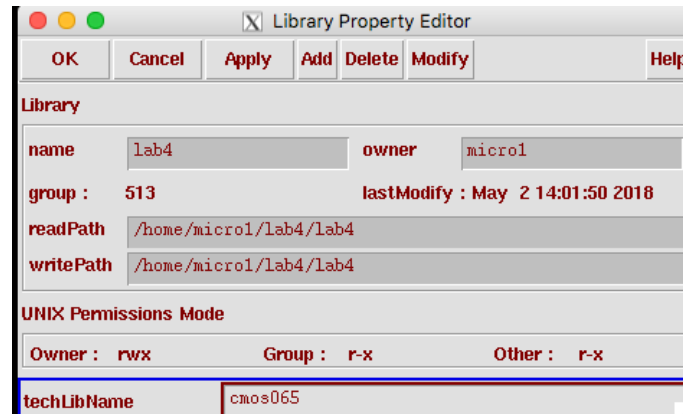
A *view* abstract (ao lado) contém as camadas de metal da célula, que são obstáculos para roteamento, e a fronteira da célula.



- **SAIR DO icfb**
- **SUBSTITUIR** no arquivo LEF todas as ocorrências de CoreSite por CORE.  
Para esta ação execute: **sed -i 's/CoreSite/CORE/g' inv.lef**

```
..
MANUFACTURINGGRID 0.005000 ;
MACRO inv
  CLASS CORE ;
  FOREIGN inv 0 0.2 ;
  ORIGIN 0.000 -0.200 ;
  SIZE 0.600 BY 2.600 ;
  SYMMETRY X Y ;
  SITE CORE ;
  PIN A
```

- Um **erro** observado nesta etapa é o **layout** ficar **desvinculado** da biblioteca, e os retângulos do inversor "desaparecerem". Para resolver este problema, no *library manager* exibir as propriedades da biblioteca e em *techLibName* digitar *cmos065*:



## 8 - CARACTERIZAÇÃO ELÉTRICA – Geração do LIB

O objetivo desta etapa é gerar um arquivo com informações de atraso e consumo da célula projetada.

### Ir para o diretório: **characterization**

- Olhar o conteúdo dos arquivos **liberate.tcl**, responsável por definir o simulador utilizado, o nome dos nodos de alimentação, além da célula que vamos caracterizar, neste caso o *inv*. Se houver várias células para se caracterizar, podemos por um \* e a ferramenta caracteriza tudo.
- Este arquivo define os parâmetros para caracterização, como as condições de operação (nominal – 1V 25C).

Executar os seguintes comandos para realizar a caracterização da célula:

```
cd characterization/
module purge
module load liberate/151 mmsim/141
liberate liberate.tcl
```

- O resultado é o arquivo **inv.lib**. Agora temos nossa célula no formato *liberty*: **inv.lib**. Este formato é um padrão, que contém informações de consumo de potência da célula, seus pinos de entrada e saída, sua função lógica, os tempos nos arcos da célula (tempo de propagação de um valor da entrada para saída) e as capacitâncias de entrada e saída. Estas informações são utilizadas pela ferramenta para geração de relatórios e validação do funcionamento dos projetos que vierem a utilizar esta célula.

Por exemplo:

```
...
cell_fall (delay_4x5) {
    index_1 ("0.003, 0.08, 0.16, 0.31");
    index_2 ("0.001, 0.003, 0.01, 0.025, 0.08");
    values (
        "0.00768426, 0.0140939, 0.0362238, 0.0835454, 0.256948", \
        "0.0165469, 0.0285835, 0.0574656, 0.104479, 0.277346", \
        "0.0185872, 0.0343237, 0.072064, 0.127893, 0.299397", \
        "0.0189462, 0.0390662, 0.0878143, 0.160094, 0.342244" \
    );
}
..
```

Neste trecho do arquivo *lib* temos o atraso (em *ps*) para 4 valores de carga de saída (*index\_1*) e 5 valores de rampa de entrada no pino A (*index\_2*). Obviamente quanto maior a carga e maior a rampa de entrada, maior o atraso.

- Abrir o datasheet gerado para a célula: [firefox datasheet/index.html](#). Esta página exibe os dados de caracterização elétrica da célula projetada.

inv\_datasheet Library

Cell Groups

INV

INV

inv\_datasheet Cell Library: Process , Voltage 1.00, Temp 25.00

Truth Table

INPUT	OUTPUT
A	Z
0	1
1	0

Pin Capacitance Information

Cell Name	Pin Cap(pF)	Max Cap(pF)
	A	Z
inv	0.00103	0.08000

Leakage Information

Cell Name	Leakage(nW)		
	Min.	Avg	Max.
inv	0.00000	12.92730	17.05510

Delay Information

Delay(ns) to Z rising :

Cell Name	Timing Arc(Dir)	Delay(ns)		
		Min	Mid	Max
inv	A->Z (FR)	0.00807	0.08152	0.37331

Delay(ns) to Z falling :

Cell Name	Timing Arc(Dir)	Delay(ns)		
		Min	Mid	Max
inv	A->Z (RF)	0.00767	0.07205	0.34223

Power Information

Internal switching power(pJ) to Z rising :

Cell Name	Input	Power(pJ)		
		min	mid	max
inv	A	0.00000	0.00000	0.00000
	A	0.00051	0.00094	0.00089

Internal switching power(pJ) to Z falling :

Cell Name	Input	Power(pJ)		
		min	mid	max
inv	A	0.00000	0.00000	0.00000
	A	0.00000	0.00036	0.00030

## 9 - SÍNTESE LÓGICA

Este passo é responsável por fazer o mapeamento de uma descrição RTL (VHDL) para a implementação em uma dada tecnologia, usando células disponíveis na biblioteca para implementar a mesma lógica descrita no RTL.

Ir para o diretório: **synthesis**

Configurar a ferramenta de síntese lógica:

**module purge**  
**module load genus/181**

- O primeiro arquivo a analisar é o **load.tcl**.
  - Na linha 11 definimos o TOP a ser sintetizado: *set DESIGN\_TOP "anel"*.
  - Na linha 23 deste arquivo (comando *set\_db library*) indicamos que vamos utilizar o inversor previamente caracterizado: *../characterization/inv.lib*, além das células da biblioteca cmos065.
  - Na linha 25 deste arquivo (comando *set\_db lef\_library*) indicamos a geometria da célula projetada: *../inv.lef*, além das células da biblioteca cmos065.

- O segundo arquivo é o que contém os parâmetros para a síntese - **cmd\_genus**:

```
include load.tcl
read_hdl -vhdl anel.vhd

elaborate ${DESIGN_TOP}

#Post synthesis reports
report_area > ${REPORTS_PATH}/${DESIGN_TOP}_area_synth.txt
report_timing > ${REPORTS_PATH}/${DESIGN_TOP}_timing_synth.txt
report_power > ${REPORTS_PATH}/${DESIGN_TOP}_power_synth.txt
report_gates > gates.txt

#Generate sdc pos synthesis
write_sdc > ${OUTPUTS_PATH}/${DESIGN_TOP}.sdc

#Generate sdf pos synthesis
write_sdf > ${OUTPUTS_PATH}/${DESIGN_TOP}_synth.sdf

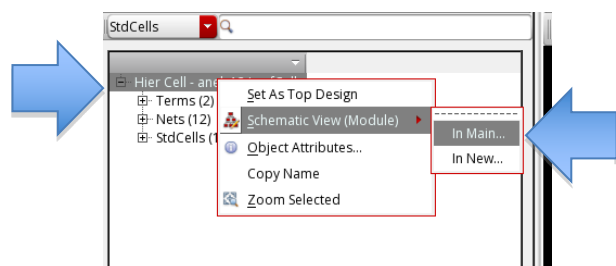
#Build physical synthesis environment
write_design -innovus -base_name layout/${DESIGN_TOP}
```

- No diretório src há o arquivo que iremos sintetizar, um anel de inversores, com 10 instâncias do inversor projetado e uma porta NAND (HS65\_GS\_NAND2X2) da biblioteca de células: **anel.vhd**.

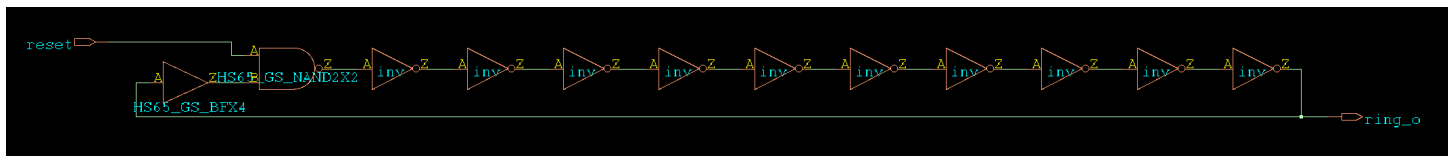
- Invocar a ferramenta de síntese lógica: **genus -gui**

- Executar o seguinte comando para realizar a síntese lógica: **include cmd\_genus**

- Agora podemos visualizar o circuito gerado pela ferramenta. Na interface gráfica selecione o *anel* e abrir o esquemático, como na figura ao lado.



- O resultado é apresentado abaixo. Observar que a ferramenta instanciou corretamente os 10 inversores, a NAND da biblioteca, e um buffer (HS65\_GS\_BFX2) para quebrar o laço de realimentação.



- Executar o relatório de área: **report\_gates**

```
=====
Generated by:      Genus(TM) Synthesis Solution 18.14-s037_1
Generated on:      Apr 07 2023 07:59:29 pm
Module:            anel
Operating conditions: PVT_1V_25C
Interconnect mode: global
Area mode:         physical library
=====
```

Gate	Instances	Area	Library
HS65_GS_BFX4	1	2.080	CORE65GPSVT
HS65_GS_NAND2X2	1	2.080	CORE65GPSVT
inv	10	15.600	inv
-----			
total	12	19.760	

Library	Instances	Area	Instances %
CORE65GPSVT	2	4.160	16.7
inv	10	15.600	83.3

Type	Instances	Area	Area %
inverter	10	15.600	78.9
buffer	1	2.080	10.5
logic	1	2.080	10.5
physical_cells	0	0.000	0.0
-----			
total	12	19.760	100.0 total \

- ☐ Para sair: **exit**

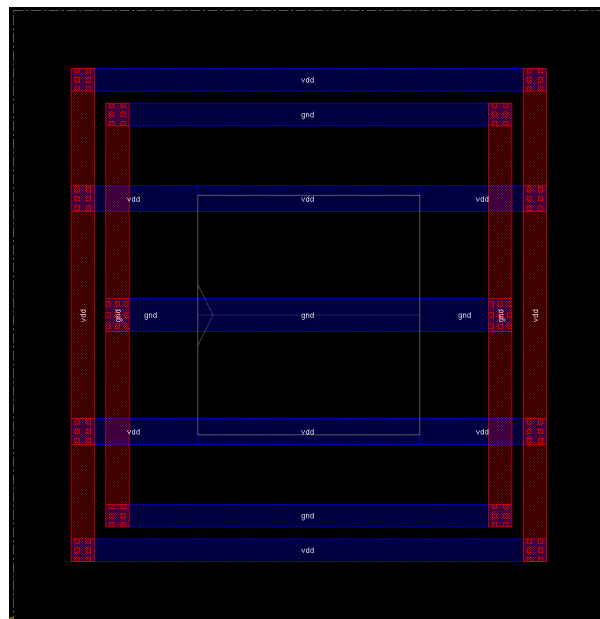
## 10 - SÍNTESE FÍSICA

Permanecer no diretório **synthesis**.

Configurar a ferramenta de síntese lógica: **module load innovus/181**

- ☐ Invocar a ferramenta de síntese física: **innovus -common\_ui**
- ☐ Executar o comando no terminal: **source cmd\_innovus**

Os 3 primeiros passos do script criam os anéis de alimentação, e definem uma região com duas linhas para as células do circuito. Notar que a linha inferior de células terá as células espelhadas, para a correta conexão à alimentação. A alimentação é implementada na horizontal com metal 1 e na vertical com metal 2. As principais etapas executadas por este script são:

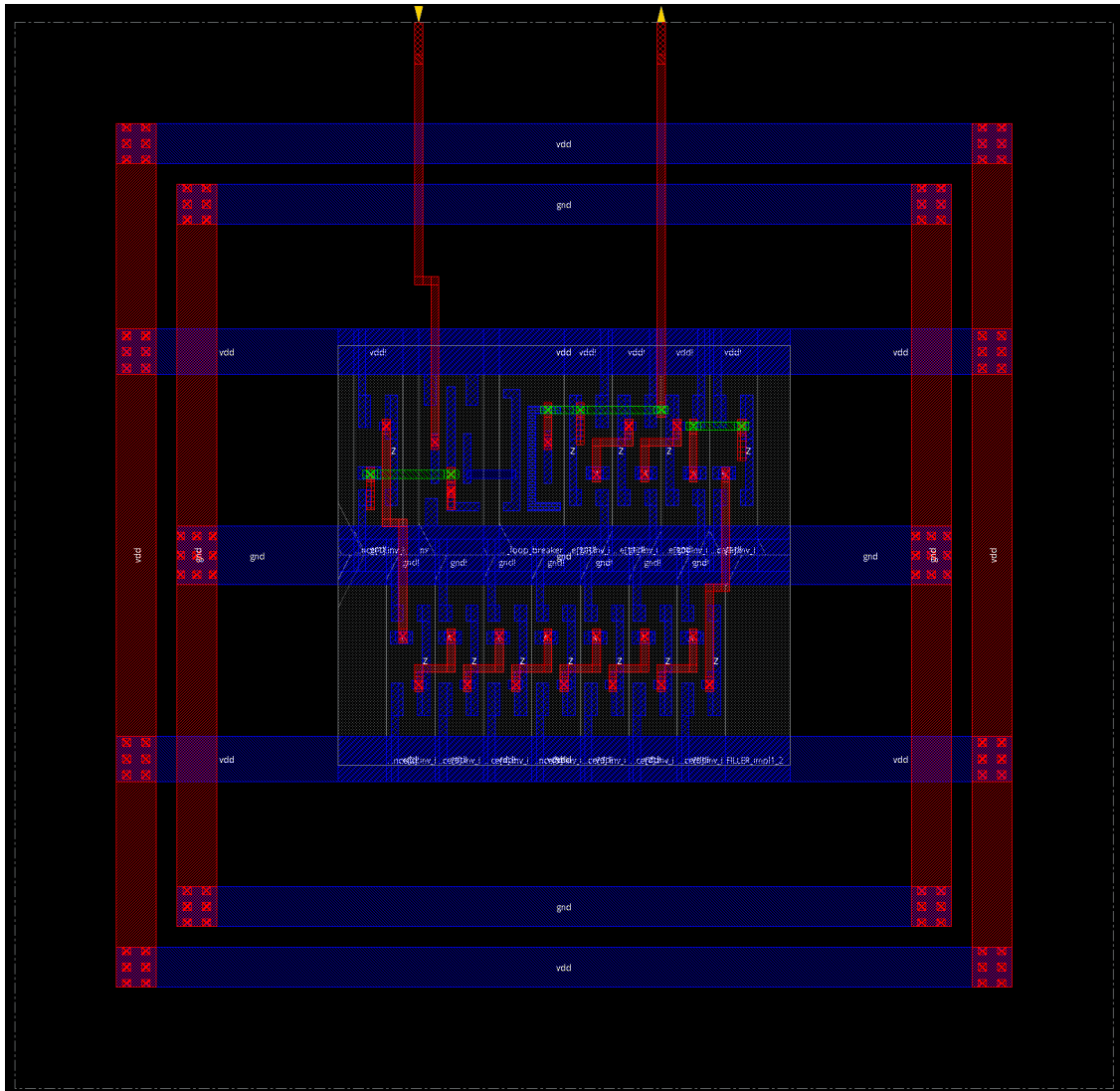


- **Leitura do projeto:** Lê o circuito
- **Floorplanning:** Etapa onde é decidido qual a porcentagem do chip que utilizada para o circuito
- **Power Planning:** Posiciona as linhas de alimentação no chip



Os passos 4 e 5 do script posicionam e roteiam as células do circuito. Notar que há espaços vazios, que ainda devem ser preenchidos. As principais etapas executadas por este script são:

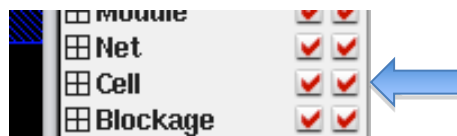
- **Placement:** Posiciona as células no chip
- **Roteamento:** Inserção dos fios de interconexão



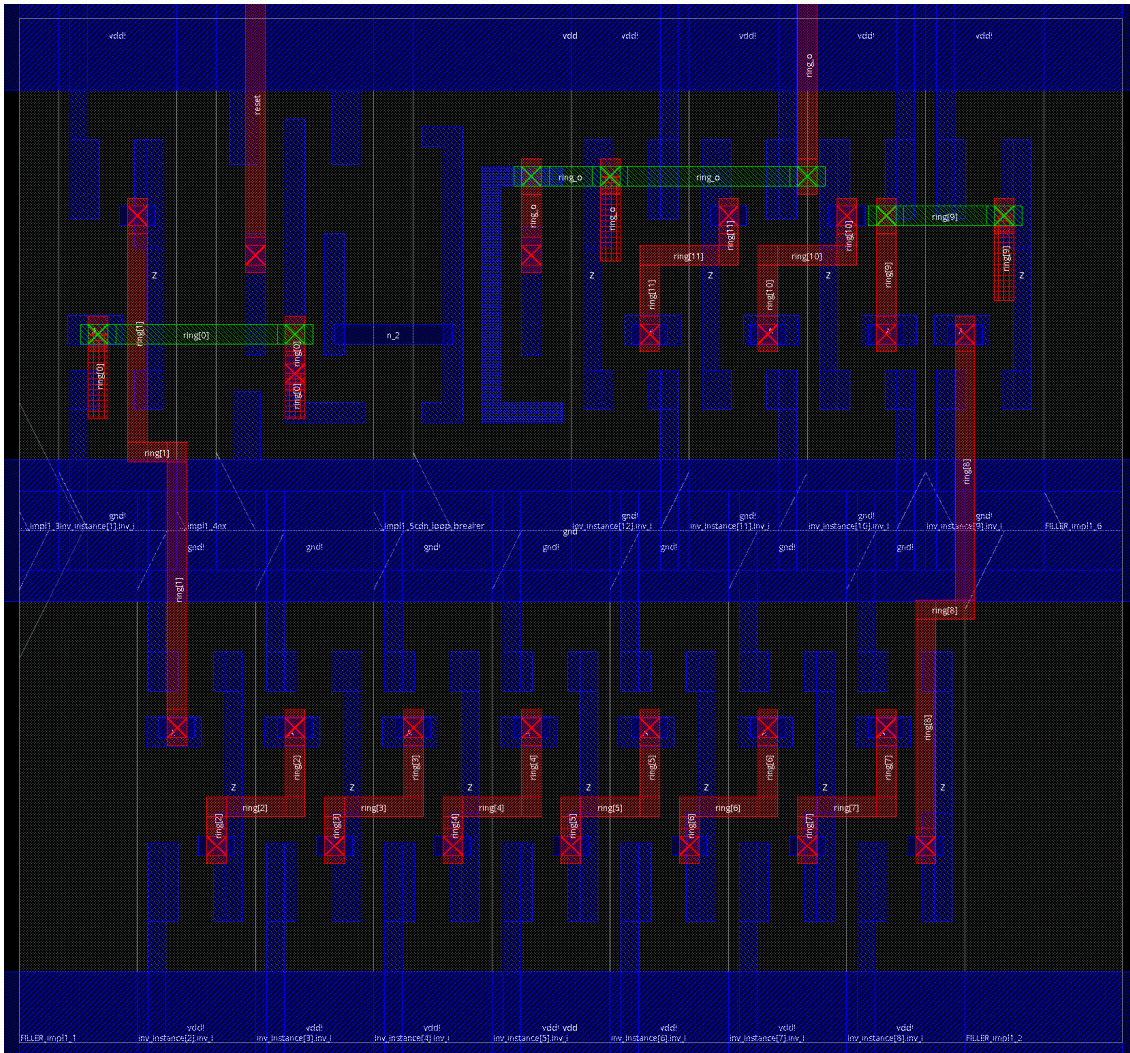
A parte final script completa o layout e gera uma de verificações. As principais etapas executadas por este script são:

- **Inserção das filler-cells:** Inserção de células para preenchimento do espaço do chip
- **DRC**
- **Geração dos relatórios**

Assim, nosso circuito utilizando inversores está finalizado. Selecione a opção para visualizar as linhas de metal internas à célula:



Na tela abaixo pode-se visualizar as conexões entre os inversores, com o metal1 interno das células:



```
@innovus 5> check_drc
*** Starting Verify DRC (MEM: 982.6) ***

VERIFY DRC ..... Starting Verification
VERIFY DRC ..... Initializing
VERIFY DRC ..... Deleting Existing Violations
VERIFY DRC ..... Creating Sub-Areas
VERIFY DRC ..... Using new threading
VERIFY DRC ..... Sub-Area: {0.000 0.000 12.800 13.200} 1 of 1
VERIFY DRC ..... Sub-Area : 1 complete 0 Viols.

Verification Complete : 0 Viols.

*** End Verify DRC (CPU: 0:00:00.0 ELAPSED TIME: 0.00 MEM: 0.0M) ***.
```

Finalmente, podemos conferir a área do layout gerado:

**> report\_area**

```
@innovus 6> report_area
Depth Name #Inst Area (um^2)
-----
0 ane1 12 19.76
```

**EXIT e**